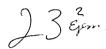
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJAKA

INCORPORADA A LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO

ESCUELA DE INGENIERIA





TILIS CON FALLA DE ORIGEN

"MANUAL DE PRACTICAS DEL LABORATORIO DE ELECTRONICA DE POTENCIA".

TESIS PROFESIONAL

OBTENER OUF MECANICO **FLECTRICISTA** INGENIERO SILVA MARIO ALBERTO DIAZ 1986 GUADALAJARA, JAL.





UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis Digitales Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis está protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

INTRODUCCION	1
PROLOGO AL ESTUDIANTE	3
MATERIALES Y REGIMENES	1
MATERIALES SEMICONDUCTORES	
RESISTIVIDAD	
REGIMENES DE LOS DISPOSITIVOS	
TIPOS DE REGIMENES	
INTRODUCCION A LOS CIRCUITOS RECTIFICADORES_	7
ANALISIS DE LA CIRCULACION DE PORTADORES	
SILICIO TIPO " N "	
SILICIO TIPO " P "	
JUNTURAS P-N	
CONDICIONES DE POLARIZACION INVERSA	
CONDICIONES DE POLARIZACION DIRECTA	
CARACTERISTICAS ELECTRICAS	15
CURVA CARACTERISTICA	
CAIDA DE TENSION DIRECTA	
CAIDA DE TENSION INVERSA	
TIEMPO DE RECUPERACION INVERSA	
PRACTICA NO. 1	18
RECTIFICADOR MONOFASICO DE MEDIA ONDA	
PRACTICA NO. 2	22
RECTIFICADOR MONOFASICO DE ONDA COMPLETA	
PRACTICA NO. 3	26
RECTIFICADOR TRIFASICO DE MEDIA ONDA	
PRACTICA NO. 4	28
RECTIFICADOR TRIFASICO DE ONDA COMPLETA	

INTRODUCCION A LOS DIODOS CONTROLADOS	_ 30
TIRISTORES	
RCS	_ 31
CURVA CARACTERISTICA DEL RCS	
CURVAS CARACTERISTICAS DE COMPUERTA	
TRIAC	. 37
CURVA CARACTERISTICA	
PRACTICA NO. 5	40
RECTIFICADOR CONTROLADO DE SILICIO	
PRACTICA NO. 6	45
RECTIFICADOR CONTROLADO DE SILICIO ACTIVADO CON LUZ	
PRACTICA NO. 7	48
CONTROL DE POTENCIA DE CD POR RCS	
PRACTICA NO. 8	52
CONTROL DE FASE	
PRACTICA NO. 9	55
CONTROL DE FASE POR RED RC	
PRACTICA NO. 10	58
CIRCUITO DE MEDIA ONDA DE CONTROL DE FASE POR RC/SUS	
PRACTICA NO. 11	61
TRANSISTOR DE UNIJUNTURA (UJT)	
PRACTICA NO. 12	66
OSILADOR DE RELAJACION	
PRACTICA NO. 13	70
CIRCUITO DE DISPARO UTILIZANDO PUT	
PRACTICA NO. 14	75
ring a co	

PRACTICA NO. 15	. 79
DIAC	
PRACTIÇA NO. 16	. 82
CIRCUITO DE CONTROL DE FASE DIAC/TRIAC	
PRACTICA NO. 17	. 85
CONTROL DE FASE CON SBS-TRIAC	
ESPECIFICACIONES SOBRE EL DISENO DEL EQUIPO	. 89
PROCESO DEL DISENO	
BIBLIOGRAFIA	93

INTRODUCCION

Actualmente la Universidad Autonoma de Guadalajara imparte la asignatura Electronica de Potencia, para los alumnos que cursan la carrera Ingeniero Mécanico Electricista en el area de Sistemas Electricos, El curso tiene como objetivo el de analizar y diseñar circuitos electronicos de potencia de uso industrial, considerando las características, limitaciones y protección de los dispositivos eléctronicos.

El presente proyecto ennumera una serie de practicas de laboratorio que siguen el plan de estudios propuesto por la UNAM, para la materia Electronica de Potencia y tiene como finalidad el de infundir en el estudiante de la asignatura, un entendimiento y confianza en un nuevo y amplio campo de conocimientos teorícos, desarrollando ejemplos practicos que deben estar en la reserva del conocimiento de los jovenes estudiantes de Ingenieria Electrica, que se ven interesados por el area de control y protección en potencia.

Con este conocimiento el estudiante adquiere las bases para continuar el aprendizaje sobre semiconductores de potencia, ya que en los últimos anos se han mejorado significativamente las características de operación de estos dispositivos lo que ha provocado que el area de acción de los mismos crezca a pasos agigantados, vislumbrandose un amplio horizonte para la aplicación de estos elementos en sistemas de conversión de potencia.

En el capitulo I se hace una breve reseño sobre las principales características de los materiales semiconductores mas comunmente usados y se enumeran los mas importantes regímenes establecidos para los dispositivos de estado solido utilizados en el presente trabajo.

Numerosas ramas de la industria metal mécanica necesitan de tesión directa para diversos procesos. El capítulo ll trata de que el estudiante se interese y comprenda las principios básicos de los circuitos rectificadores, con experimentos poco complicados pero completas para el nivel de visualización del estudiante.

El conftulo 111 describe la manera como se nuede controlar la energía suministrada a una carga utilizando ah estado solido. 105 elementos Analiza dispositivos · semiconductores mas utilizados para el control y conversión de potencia. Muestra ejemplos de sistemas sencillos que ilustran plenamente los principios que el estudiante puede aplicar. Estos principios conducen a la comprensión de sistemas mas complejos que proveen los requisitos de una sociedad que se industrializa cada dia mas.

El objetivo es, pues, despertar el interes del estudiante, nutrir y acrecentar su apetito por el conocimiento, ademas de desarrollar su destreza y habilidad practica que le serán de útilidad en un futuro o para toda la vida de ser interiorizadas adecuadamente.

PROLOGO AL ESTUDIANTE

Al utilizar este manual de prácticas, se deben tener en cuenta varias consideraciones necesarias para obtener mejores resultados en los experimentos; estos se anotan a continuación;

Verifique que el equipo de prueba y las conexiones a tierra en los circuitos esten unidas a un punto común, y que los intrumentos de medición se coloquen en la posición señalada del circuito como muestran los diagramas. La mala colocación de los instrumentos de medición puede provocar cargas en el circuito y pequeñas diferencias de potencial entre los distintos puntos a tierra, lo que puede provocar inexactitudes en la medición.

Debido a que las técnicas de medición apropiadas y los datos exactos son un requisito indispensable para lograr resultados más confiables, se recomienda calibrar los instrumentos de medición y verificar el circuito al iniciar cualquier experimento; para localizar conexiones defectuosas y evitar fallas en las aplicaciones o funcionamiento del equipo de prueba.

Por último y como ya se ha señalado, los manuales de operación de los intrumentos, componentes y dispositivos usados en los experímentos, son fuente primaria de información con relación a capacidad y liritaciones de los mismos.

Se aconseja al estudiante consultarlos antés de cada experimento para que este enterado de los regímenes y características limitativas de los dispositivos de estado solído.

MATERIALES Y REGIMENES

GENERALIDADES

Los dispositivos de estado solído son elementos de tamaño reducido pero versatiles que pueden ejecutar una gran variedad de funciones de control en los equipos eléctronicos. Al igual que otros dispositivos eléctronicos, son capaces de controlar instantaneamente el movimiento de cargas eléctricas. Se les útiliza como amplificadores, osciladores, mezcladores, moduladores, rectificadores y commutadores electronicos.

than been strong in equipment of the early

Adémas, los dispositivos de estado solído poseen numerosas e importantes ventajas con respecto a los démas tipos de dispositivos eléctronicos; son de talla y peso reducido (Algunos tienen longitudes menores al centímetro y pesan apenas unos cuantos gramos); no tienen filamentos ni calefactores y por la tanto no requieren potencia de caldea o tiempo de calentamiento; consumen muy poca potencia; son de construcción solido, extremadamente resistentes y se les puede fabricar de manero que sean inmunes a severas condiciones ambientales.

MATERIALES SEMICONDUCTORES

A diferencia de otros dispositivos eléctronicos que dependen para su funcionamiento de la circulación de cargas eléctricas a través del vacio o de un gas, los dispositivos de estado solido hacen uso de la circulación de corriente en un solido. En general todos los materiales pueden clasificarse en las siguientes categorias segun su capacidad de conducir corriente:

CONDUCTORES
SEMICONDUCTORES
AISLADORES

Los materiales semiconductores mas utilizados son el Silicio y el Germanio, El Germanio tiene mayor conductividad eléctrica que el Silicio por la que se utiliza en dispositivos que requieron una caida de tensión muy pequeña o que se venn sometidos a altas temperaturas. Generalmente se profiere el Silicio al Germanio poque las técnicas de procesamiento del primero proporcionan dispositivos más económicos. Como consecuencia el Silicio tiende a remplazar al Germanio en casi todos los tipos de aplicaciones, incluyendo el campo de las señales pequeñas.

RESISTIVIDAD

La aptitud de un material para conducir corriente (conductividad) es directamente proporcional al número de eléctrones libres del material. Por lo tanto mientras mayor sea el número de eléctrones libres mejor conductor es el material. Los aisladores tienen muy pocos eléctrones unidos debilmente , tienen resistividades que alcanzan varios millones de ohms por centímetro, los buenos conductores tales como la plata y el cobre tienen gran cantidad de elctrones libres.

Los materialees semiconductores se ubison cotre dos extremos. El Germanio nuro tícne una resistividad de 60 ohms por centímetro. El Silicio puro posee una resistividad considerableemente mayor del orden de 60.000 chms nar centímetro. Sin embargo estos materiales usados 105 dispositivos de estado solido contienen cântidades controladas de ciertas impurezas 900 reducen su resistividad aproximadamente 2 ohms por centímetro a la temperatura ambiente.

REGIMENES DE LOS DISPOSITIVOS

Los regimenes establecidos para los dispositivos de estado solido sirven a los proyectistas de circuitos y equipos para sacar el máximo provecho de las capacidades de comportamiento y servicio de cada tipo.

Este programa de instrucción no considera estos especificaciones para el diseño. Como estos regímenes definen

las condiciones limites dentro de las cuáles debe mantenerse a un dispositivo para asegurar su funcionamiento satisfactoria y confiable en los equipos, se considera importante señalarlas con el fin de que el estudiante se interiorice con las principales características de las componentes que va a manejar y al mismo tiempo adquiera las bases para proyectar en un futuro sistemas complejos que provean los requisitos de una sociedad que se industrializa cada dia más.

En la industria eléctronica se utilizan tres tipos de regímenes:

SISTEMA MAXIMO ABSOLUTO SISTEMA MEDIO DE DISENO SISTEMA MAXIMO DE DISENO

Los regímenes dados en los datos técnicos para los dispositivos de estado solidose basan en el sistema máximo absoluto. Las pruebas de regímenes son costosas, insumen mucho tiempo y frecuentemente producen la destrucción de los dispositivos que se estan probando. Se asegura la valídez de los regímenes mediante estrictos controles de procesamiento, y fabricación. Ademas de amplios controles de colidad en cada etapa del proceso de producción.

TIPOS DE REGIMENES

Los regímenes se dan para aquellos factores causantes de esfuerzos que pueden provocar una degradación en las características del funcionamiento o la eventual falla del dispositivo, a menos que se mantengan dichos factores dentro de ciertos límites. La tabla A enumera los factores criticos de los regímenes usados para especificar las capacidades de operación seguras de los tipos de dispositivos que nos interesan para el presente programa.

3C 3C

representation and the second of the contract of the contract

INTRODUCCION A LOS CIRCUITOS RECTIFICADORES

GENERALIDADES

Muchos componentes eletronicos se alimentan con corriente continua, que se puede obtener de la red externa alterna, si se intercala un rectificador. Así, un rectificador es un componente que conectado a una red alterna proporciona corriente continua.

Los rectificadores de potencia se fabrican sobre todo. utilizando como materias primas Silicio o Germanio. La pureza muy elevada es una condición básica. For ejemplo, por cada l El3 atomos de Silicio se admite la existencia de un solo atomo de impurezas. Un centímetro cubico contiene cerca de .1 E23 atomos. Tal grado de pureza es equivalente a que en un deposito de aqua de 50x12.5x2 metros llano de aqua pura, el volumén de impureza no sea mayor que una gota de 0.6 mm de diametro. Como el Silicio tiende a remplazar al Germanio en la mayoria de las aplicaciones de semiconductores a continuación analizaremos la. estructura de un rectificador de Silicio. (Cuyo funcionamiento es identico al de un rectificador construido de Germania)

Los rectificadores de Silicio sun esencialmente celulas con una juntura P-N simple. Como resultado de ella poseen una baja resistencia a la circulación de corriente en un sentido (DIRECTO), pero alta resistencia en el otro sentido (INVERSO). Pueden funcionar con temperaturas ambiente de mas de 200 °C, con corrientes de varios centenares de amperes y tensiones superiores a los 1000 Volts. Además pueden disponerse en paralelo o en serie para trabajar con corrientes o tensiones elevadas. Esto último, no es recomendable por que estas conexiones pueden acarrear graves problemas incluso la destrucción de los diodos, ya que, aunque sean elementos de una misma denominación, sus características directas e inversos y

sus tiempos de recuperación nunca serán iguales.

Gracias a que la relación entre corrientes directa e inversa es elevada, los rectificadores do Silicio pueden lagrar rendimientos superiores al 99%. Cuando son utilizados correctamente alcanzan una larga vida util, ya que no los afectan la acción del tiempo, la humedad y la temperatura. Son de pequeño tamaño y procio reducido y son muy resistentes a las vibraciones y otras condiciones adversas.

El funcionamiento de un rectificador puede explicarse convenientemente analizando la circulación de portadores de cargo a través de la juntura P-N tanto en condiciones de polarización inversa como directa. También se puede analizar la distribución de potencial en la juntura, en cada condición de polarización; con el fín de predecir el comportamiento del rectificador.

ANALISIS DE LA CIRCULACION DE PORTADORES

Para lograr un entendimiento completo de la teoría del funcionamiento del rectificador de Silicio, a continuación se analizará la estructura cristalina de este material.

Un átomo se compone de núcleo y electrones. Cada electron posee una carga elemental negativa que se mueve en torno al núcleo positivo. Los electrones de un atomo circundan al núcleo, recorriendo capas fijas, separadas cierta distancia del núcleo (fig. 1).

Figura 1 Representación esquemática del átomo de silicio. En lorno al núcleo giran 14 electrones. En la capa interna, 2 electrones, en la intermedia, 8, y en la capa de valencia, 4.

Los electrones de la capa externa son los responsables de los enlaces entre los diversos átomos del material. Determinan la valencia de este y reciben el nombre de electrones de valencia. Estas particulas se pueden alejar del átomo mediante un incremento de energía, como la producido por el calor, la lúz o el potencial eléctrico.

El Silicio se cristaliza en el sistema cubico de átomos centrales, se caracteriza por tener cuatro electrones en la capa de valencia, que se combinan con los electrones de átomos adyacentes, ejerciendo sobre estos una fuerza de atracción y constituyendo pares electrónicos cuya ruptura es dificil.

Debido a que tal estructura no tiene electrones unidos debilmente, los materiales semiconductores son malos conductores en condiciones normales. Para poder separar las ligaduras covalentes y proveer electrones libres para la conducción eléctrica, es necesario aplicar altas temperaturas o campos eléctricos intensos.

Para que un cristal de Silicio puro tenga las características semiconductoras necesarias, se requiere combinar el Si, con átomos de otros elementos, lo que se conoce como impurificación. Mediante el agregado de cantidades casí infinitesimales de los elementos llamados impurezas, es posible modificar y controlar las propiedades eléctricas basícas de los materiales que poseen un electrón de valencia mas (5) o menos (3) que el Silicio.

SILICIO CON CONDUCTIVIDAD " N ."

Cundo el átomo de impureza tiene un electrón de valencia mas que el átomo del semiconductor, este electrón adicional no puede formar una ligadura covalente debido a que no hay un eletrón de valencia adyacente. El electrón excedente es entoncer atraído muy débilmente por el átomo, según la Fig. 2 y solo requiere una ligera excitación para separarse.

La presencia de tales electrones excedentes hacen al material mejor conductor.

Los elementos de impureza que se agregan a los cristales de Silicio y Germanio para proveer electrones excedentes incluyen Fosforo, Arsenico y Antimonio, el material resultante se denomina " N " debido a que los electrones libres excedentes tienen una carga negativa.

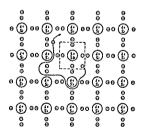


Figura 2 Estructura cristalina de Si con impurezas de Sb y un elemento resultante "n" (electronegativo). El quinto electrón, que permanece libre, se despiaza por la estructura.

STUTET CON CONTUCTIVEDAD * F *

Se produce un efecto diferente cuando en la estructura cristalina se sustituye un átomo de impureza con un electrón de valencia menos que el átomo semiconductor. Aúnque todos los electrones de valencia del átomo de impureza forman ligaduras covalentes con los electrones de los átomos vecinos del semiconductor, una de las ligaduras de la estructura cristalina no puede completarse. Como consecuencia de ello, aparece un vacio o hueco en la red cristalina como se muestra en la Fig. 3. Un electrón de la ligadura covalente adyacente puede entonces absorver suficiente energia para romper su ligadura y moverse a traves de la red para llenar el hueco.

Se considera que el lugar vacio de la estructura cristalina tiene una carga eléctrica positiva por que Εl representa la ausencia de un electrón. material semiconductor que contiene huecos o cargas positivas denomina material tipo " y se forma agregando Boro, Aluminio, Galio o Indio al semiconductor. (Fig. 3).

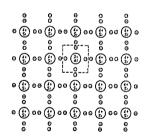
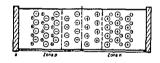


Figura 3 Estructura cristalina de Si con impurezas de Al. El elemento resultante es "p" (electropositivo).

JUNTURAS F-N

Cuando se ponen en contacto dos materiales uno tipo P y otro tipo N se produce en la linea de union llamada juntura, una interacción entre los dos tipos de materiales como resultado de los huecos en un material y de los electrones excedentes en el otro.

Cundo se forma una juntura P-N algunos de los electrones libres del material tipo N se difunden a través de la júntura y se recombinan con los huecos de la estructura cristalina del material tipo P, en forma similar algunos huecos del material tipo P se recombinan con los electrones del material tipo N al otro lado de la juntura. Esta interacción es puesta en equilibrio por una pequeña región de carga espacial, llamada región de transición o capa de deserción. El material tipo P adquiere asi una ligera carga negativa y el material tipo N una ligera carga positiva. (Fig. 4)



Como resultado del proceso de difusión o interacción se produce un gradiente de potencial a través de la región de carga espacial, que forma una barrera de energía que impide que se sigan difundiendo los portadores de carya a través de la juntura.

CONDICIONES DE POLARIZACION INVERSA

Cuando se aplica polarización inversa (Tensión positiva a la region tipo N y tension negativa a la region tipo P), se produce una distribución desequilibrada de huecos y electrones debido a que la region que rodea a la juntura P-N se vacia de portadores de carga libres. Esta redistribución se produce por que los electrones son atraidos por la tensión positiva aplicada a la región tipo N y los huecos son atraídos por la tensión negativa aplicada a la región tipo P de manera que son remplazados de las posiciones de equilibrio.

El resultado final es que los portadores se alejon de ambos lados de la juntura para crear una región de deserción o región de carga espacial, que puede soportar la tensión aplicada sin que aumente la circulación de corriente (Fig. 5). Solo circulara una pequeña corriente de fuga debido a la generación térmica de pares electron-bueco dentro de la region de deserción.

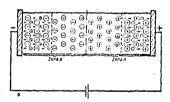


Figura 5

CONDICIONES DE POLARIZACION DIRECTA

La juntura se polariza en sentido directo cuando se aplica tensión positiva a la región tipo P y tensión negativa a la región tipo N. Esta polarización hace que los electrones y los huecos se muevan hacía la juntura y la atraviesen. En consecuencia, la concentración de portadores de carga libre en la región central de la juntura aumenta considerablemente, porque bajo la acción motora de la tensión aplicada, los huecos van de la zona P a la N, y los electrones liberados de N hacía P (Fig. 6). En estas condiciones la resistencia eléctrica de la sección F-N es pequéña. Ya no existe capa de bloqueo; incluso tensiones reducidas (del orden de magnitud de 1 Volt) si se aplican en el rectificador, pueden dar origen al paso de corrientes elevadas.

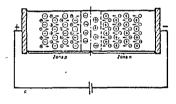


Figura 6

) Electron

.

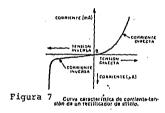
O O Posición de aelecto

Capa de

CARACTERISTICAS ELECTRICAS

CURVA CARACTERISTICA

La fígura 7 muestra la curva característica de corriente versus tensión de un rectificador de Silicio.

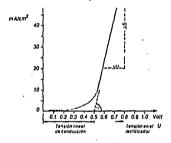


Se puede obsevar que la corriente directo es mucho mayor que la corriente inversa en el ranno de funcionamiento normal del rectificador. La pequeña corriente inversa aumenta gradualmente a1 aumentar la tensión inversa conduciendo finalmente a la runtura de la juntura, como la indica el aumento, brusca, de la corriente inversa con tensiones inversas elevadas. Otra característica importante de la curva rectificador es que la caída de tensión directa normaneco pequeña hasta la corriente nominal máxima. Los datos curvas dados para los rectificadores de Bilicio proporcionan la información que el proyectista de un circuito necesita para predecir las capacidades de su circuito y formar las bases de las regimenes que definiran los limites de funcionamiento seguro del rectificador. Es por eso que a continuacion se analizaran las características inherentes del dispositivo que se pueden considerar más importantes.

CAIDA DE TENSION DIRECTA

La principal fuente, de pérdida de potencia de un rectificador de Silicio se origina en la caida de tensión en conducción directa. Esta característica constituye, pues, la base de varios de los regímenes del rectificador. El rectificador de Silicio generalmente requiere una tensión directa de 0.4 a 0.8 volts según la temperatura y concentración de impurezas de la unión P-N.

Un ligero aumento en la tensión directa más allá de este punto produce un incremento pronunciado en la corriente directa como se muestra en la fígura 8.



La pendiente de la curva tensión-corriente con tensiones superiores a este valor de umbral representa la resistencia dinamica del rectificador, la cual depende de la construcción de la juntura y es inversamente proporcional al aréa de la pastilla de Silicio.

CAIDA DE TENSION INVERSA

Cuando se aplica una tensión de polarización inversa a través de un rectificador de Silicio circula por este una cantidad limitada de corriente de bloqueo inversa. Esta corriente es del orden de unos pocos de microamperes. Inicialmente la corriente inversa aumenta ligeramente cuando la tensión de bloqueo aumenta, pero luego tiende a permanecer relativamente constante; aun cuando la tensión inversa aumente

significativamente. Si la tensión de bloqueo inversa se incrementa continuomente llega finalmente a un valor (que varia para los diferentes tipos de rectificadores) en el cual se produce un incremento muy brusco de la corriente inversa. Esta tensión se llama tensión de ruptura o de avalancha o zenner.

Aunque los rectificadores pueden funcionar sin ricsgos en los puntos de avalancha, los mismos pueden destruirse como resultado del embalamiento térmico por hloqueo inverso. El cual es producido si la disipación inverso llega a ser tan grande que, a medido que la temperatura de juntura aumente, las pérdidas aumentén mas rápido que la velocidad de enfriamiento.

TIEMPO DE RECUPERACION INVERSA

Después de que un rectificador da Silicio ha funcionado en condiciones de polarización directa, debe transcurrir cierto intervalo de tíemos finito del orden de unos microsegundos antés de que pueda volver a la condición de polarización inverso. Este tiempo de recuperacion inverso consecuencia directa del gran aumento en la concentración de portadores de carga en la region central la juntura producido por una polarización directa. Si la polarización se invierté bruscamente, algunos de estos portadores cambian subitamente de dirección y se mueven en sentido inverso, mientros que los restantes se recombinan con los de polaridad opuesta. En razón de que hay un número finito do estos portadores en la región de deserción y no hay una fuente que proporcione los portadores de carna libres que quedan remplozar a los que se alejan de la juntura al instante de cambiar el sentido de conducción, el dispositivo finalmente pasara a la condición de polarización inversa o bloqueo. Durante este período, sín embargo, los portadores de carga constituyen una corríente inversa conocida como corriente de recuperación inversa.

PRACTICA 1 RECTIFICADOR MONOFASICO DE MEDIA ONDA

OBJETIVO:

- A.~ Comprobar y analizar el funcionamiento de los circuitos rectificadores monofásicos de media onda.
- B.- Graficar lás formas de onda de tensión en los distintos componentes para diversas condiciones de filtraje y carpa.

INFORMACION INTRODUCTORIA

El circuito rectificador mas adecuado para una aplicación particular, depende de los requerimientos de tensión y de corriente, de la magnitud de la ondulación (fluctuación indeseable que se produce en la salida de corriente continua a causa de una componete alterna) que puede tolerar el circuito y del tipo de energia CA disponible.

La conexión del rectificador de media onda se átiliza cuando no hay exigencias especiales en lo que se refiere a la variación del valor de la tensión o de la corriente rectificada. El transformador se átiliza de manera inadecuada, puesto que sólo se aprovecha la mitad de la onda senoidal. For el devanada secundario del transformador pasa apenas una corriente en uno de los sentidos haciendo que su nuclea se premagnetice. Así, por cada período pasa por el rectificador solo una media onda, y este conducira toda la circulación de corriente.

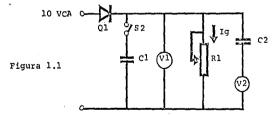
Este tipo de circuito rectificador contiene un porcentaje muy elevado de ondulación de salida (alrededor del 121%).

EQUIPO Y MATERIALES

-MODULO DE FUENTE DE ALIMENTACION	EM59821	
-MODULO DE MEDICION CD	EMS8412	
-OSCILOSCOPIO		
-MULTIMETRO ANALOGICO	* •	
-MULTIMETRO DIGITAL		
-TABLERO DE EXPERIMENTOS		
-01 Rectificador de sili	cio 1N4001	
-C1	470 <i>J</i> UF	
-C2	470 AF	
-C3	470 AF	
-R1 Resistencia variable	1 K	

PROCEDIMIENTO

1.a) Conecte el circuito de la fígura 1.1, ajuste la fuente de alimentación para el valor de 10 volts (mantenga constante la tensión para todas las mediciones) y R1 para su valor de resistencia maxima.



Inicialmente use los rangos de 25 Vcd y 25 mAcd para los medidores y verifique sus conexiones.

b) Cierre S2 y ajuste R1 para una corriente de carga Ig=8 mA y anote los valores de tensión en V1 y V2. Repita el procedimiento para una Ig=16 mA.

	•	
)1= v	V2=	v

۲)	Conecte el asciloscopio y abserve detalladam curvas de tensión en los puntos 1 y 2. Grafiquel		S
	curves as reasion en los puntos 1 y 2, branidasi	421	
d)	Cambie la escala de los medidores a 20 V cd, al cierre S1. Anote los valores de tensión en V1 y C		Y
	V1=v V2=	v	
	El valor apròximado de V1 sera el valor de la ter la fuente por raíz de 2	ısiön e	п
e)	Cierre S2 y ajuste R1 para una Ig=8 mA; a con para un Ig=16 mA. Anote los valores de tensión V2.		
	V1=v V2=	v	
	V1=v	v	
f.)	Conecte en paralelo al capacitor C1, el capacit repita el procedimiento del inciso anterior.	.or 83 to	,
	Se incrementaron las tensiones? Porqué?		
g)	Grafique con ayuda del osciloscopio las cu tension en 1 y 2.	rvas de	9

Abra Si y S2 y mida ,los valores de Vi y V2. Con los

valores obtenidos determine la andulación del circuito.

h)

% andulación= V2*100 /V1 ≈

El voltímetro V2 registra la componente alterna que existe todavia en la tensión rectificada. El capacitor de 470 MF tiene la función de evitar la acción de la tensión continua sobre el instrumento.

PRUEBA DE CONOCIMIENTOS

- 1.- Que función tiene el capacitor de filtrado en el circuito?
- 2.- Que pasa si se varía la capacidad del capacitor y la carga se mantiene constante.
 - a) Con la tensión en la carga.?
 - b) Con la andulacion?
- 3.- Cambia la ondulación con la carga?

PRACTICA 2 RECTIFICATOR MONOFASICO DE ONDA COMPLETA

OBJETIVO:

- A.- Se comprobará el funcionamiento de un circuito rectificador de onda completa.
- B.- Se graficarán las curvas de tensión en algunos elementos del circuito, para diversas condiciones de filtraje y carga.

INFORMACION INTRODUCTORIA

Con un rectificador de onda completa, se obtiene mayor aprovechamíento de energía, los tipos mas comunes son el de conexión central y el de conexión en puente. Se utiliza la conexión con derivación central cuando se desea rectificar corrientes elevadas ante tensiones de red de un valor de hasta la mitad del valor nominal del rectificador. Este tipo de conexión utiliza dos rectificadores, en cada rectificador se puede aplicar solo la mitad de la tensión alterna nominal.

Un circuito rectificador en puente para corriente alterna monofásica tiene siempre 4 rectificadores o un número multiplo de 4. En cada dirección de la corríente se encuentra siempre la mítad de los rectificadores existentes, en serie. Se puede exponer a cada rectificador individual a la mitad de la tensíon inversa de pico para la misma tensión de salida. A través de cada rectificador circula sólo el 50 % de la corriente total. Este circuito, por no tener transformador punto medio, proporciona el doble de voltaje de salida que el de un circuito con derivación central con la misma tensión de tranformador.

La ondulación del circuito de rectificador de onda completa es alrededor del 48 %,

EQUIPO Y MATERIALES

-MODULO DE TRANSFORMA	DOR	EMS8341
-MODULO DE FUENTE DE	ALIMENTACON	EMS8821
-OSCILOSCIPIO		
-MULTIMETRO ANALOGICO		
-01,02,03,04	RECT. DE SI.	1.04001
-R1	RES. VARIABLE	1.K
-C1		470 MF

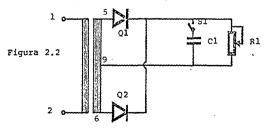
-TABLERO DE EXPERIMENTOS

PROCEDIMIENTO

1. a) En la primera parte de esta práctica se comprobará el funcionamiento de un circuíto rectificador con conexión de derivación central. Si no existe un transformador con derivación central accesible, creese un punto central artificial con una resistencia como lo muestra la fig. 2.1.



Conécte el circuito de la fíg. 2.2, en seguida ajuste la salida de la fuente de alimentación a 25 Vca, use el modulo de transformador monofásico EMS8341 y conectelo como muestra la fíg. 2.2. Calibre los medidores y ajustelos a los rangos de 2.5 Acd y 20 Vcd.



b) Ajuste R1 para que circule a través de la carga una corriente de 16 mA, anote el valor de tensión.

				_			
u)==	١.	"	า1	t	. •	i

 c) Conecte el osciloscopio y grafique la forma de onda de la tensión observada en la carga.

Cuántos pulsos de energia recibe la resistencia de carga, en un período?

d) Cierre el interruptor S1 y ajuste R1 para que circule por la carga una corriente de 8 mA. Anote el valor de tensión en la carga y con ayuda del osciloscopio grafique la forma de onda en la misma.

/=	volts

2.a) A continuación se mostrará la operación de un ciruito de onda completa conectado en puente.

Conecte el circuito de la fig. 2.3. Ajuste la fuente de energía para que proporcione un tensión de 25 Vca y ajuste los rangos de los medidores a 25 Vcd y a 2.5 Acd.

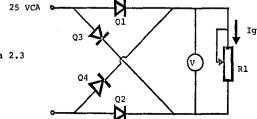


Figura 2.3

b) Ajuste R1 para que circule una corriente de carga Ig \approx 30 mA. Anote el valor de la tensión en la carga y utilizando el osciloscopio grafique la forma de onda.

U≔	~valt•

El rectificador de onda completa conectado en puente para la misma tensión en el transformador que en el caso anterior nos proporciona un valor de tensión doble.

PRUEBA DE CONOCHMIENTOS

- 1.- Anote ventajas y desventajas de los rectificadores de conexión puente y derivación central.
- 2.- Pórque el rectificador tipo puente proporciona el doble de tensión que el de derivación central para las mismas condiciones de transformación?
- 3.- Que tensión inversa soportan los rectificadores en los dos tipos de circuitos?

PRACTICA 3 RECTIFICADOR TRIFASICO DE MEDIA ONDA

OBJETIVO

- A.- Comprobar el funcionamiento de un circuíto rectificador trifásico de media onda con conexión en estrella.
- B.- Graficar las curvas de tensión en los distintos componentes del circuita.

INFORMACION INTRODUCTORIA

La conexión rectificadora en estrella, es la canexión trifásica más simple y puedo considerarse que esta formada por tres circuitos monofásicos conectados a un punto común en unas de sus extremidades, a través del punto de estrella del secundario de un transformador trifásico. El primario del transformador se conecta en triangulo para evitar que se pierda la simetría de las tensiones de la red, por desequilibrio en las fases del secundario. El circuita trifásico de media onda en estrella utiliza tres recificadores. Este circuito tiene mucha menos ondulación que los circuitos mencionados anteriormente (alrededor del 18% de ondulación). Adémas, a través de cada rectificador circula un tercio de la corriente de salida total.

EQUIPO Y MATERIALES

-FUENTE DE ALIMENTACION

EMS8821

_MODULO DE MEDICION CD

EMS8412

OSCILOSCOPIO

MULTIMETRO DIGITAL

Q1,02,03 RECTI

RECTIFICADOR SI 1N4001

_B1

RES VARIABLE 1 K

_ TADLERO DE EXPERIMENTOS

PROCEDIMIENTO

1.- a). Conecte el circuito de la figura 3.1, ajuste la fuente de alimentación aun valor de 25 Vca, ponga el rango de los medidores a 20Vcd y 250 mA. Ajuste el valor de la resistencia R1 a su valor máximo.

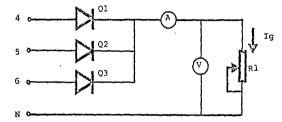


Figura 3.1

b) Disminuya lentamente la resistencia RI, hasta que la corriente de carga Ig≃30 mñ. Lea y anote el valor de la tensión en la carga al igual que la corr∫ente a través del diodo.

V= volts I=	mA
-------------	----

c) Conecte el osciloscopio en el punto 1 y grafique la forma de onda de tensión a través de la carga.

PRUEBA DE CONOCIMIENTOS

- 1.- Cuál es el número de pulsos por período que recibe la carga?
- 2.- Que proporción de la corríente total en la carga círcula a través de cada diodo?

PRACTICA 4 RECTIFICADOR TRIFASICO DE ONDA COMPLETA

OBJETIVO:

- A.- Comprobar el funcionamíento de un circuito rectificador de onda completa con conexión trifósica en quente.
- B,- Graficar la curva de tensión a la salída del rectificador.

INFORMACION INTRODUCTORIA

La conexión trifásica en puente, es una de las conéxiones trifásicas más comúnes y más utilízadas, ya que la onda de tensión y corriente a la salida, sin filtros tiene solo una ondulación de solo 4.2%. En la mayoria de los casos se puede considerar como corriente continua. Además esta conexión entrega el doble de tensión de salida que el rectificador trifásico de media onda conectado en estrella para las condiciones del mismo transformador. El número de pulsos por período a la salida es de seis. El secundario del transformador puede estar conectado en estrella o en delta ya que no ocupa el punto en estrella neutro.

EMS8821

EQUIPO Y MATERIALES

- _ FUENTE DE ALIMENTACION
- OSCILOSCOPIO
- MULTIMETRO ANALOGICO
- _ R1, R2, R3, R4, R5, R6 RECT SI 1N4001
- _ RI RES VAR I K
- MODULO DE MEDICION
- TADLERO DE EXPERIMENTIOS

PROCEDIMIENTO

1.- a) Se conecta el circuito de la fígura 4.1, ajusto la fuente de alimentación para que proporcione una tensión de 25 Vca entre fases, y la resistencia Ri a su valor máximo.

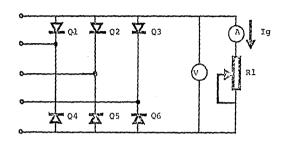


Figura 4.1

b) Ajuste las escalas de los medidores a 50 Vcd y 2.5 Acd, disminuya la resistencia de R1 hasta que la corriente de carga Ig=40 mA. Anote el valor de la tensión en la resistencia de carga.

r:==	Volts

- c) Conecte el osciloscopio en el punto 1 y grafique la forma de onda de la curva de tensión en la carga.
- d) Cuántos pulsos por período recibe la resistencia de carga?

PRUEBA DE CONOCIMIENTOS

- 1.- Que ventajas tiene la conexión rectificadora trifósica en puente?
- 2.- Qué tensión inverso soportan los diados?
- 3.- Esta conexión necesita de filtros a la salida?

TIL

INTRODUCCION A LOS DIODOS CONTROLADOS

TIRISTORES

Los tiristores son dispositivos de estado solido cuyas características son similares a las de las valvulas tiratrón. Más especificamente son interruptores de estado sólido cuyo estado estable depende de la realimentación positiva asociada a una estructura PNPN. Básicamente este grupo incluye cualquier dispositivo semiconductor biestable, con tres o mas junturas que puede pasarse de un estado de alta impedancia a un estado de conducción y viceversa, dentro de un cuadrante por lo menos de las curvas características de la tensión principal.

Existen varios tipos de tiristores, los cuales difieren en el námero de electrodos terminales y en las características de funcionamiento en el tercer cuadrante (negativo) de las curvas características de tensión-corriente. Los tipos más comunes y los cuales vamos a analizar más a fondo son los tiristores triodicos de bloqueo inverso, llamados comunmente rectificadores controlados de Silicio (RCS) y los tiristores triodicos bidireccionales, conocidos como TRIACS.

RCS

Un RCS es básicamente un dispositivo unidireccional PNPN de cuatro capas proyectado para proporcionar conmutación biestable cuando funciona con polarización directa. El dispositivo tiene 3 electrodos, llamados cátodo, ánodo y compuerta (fig 3,1),

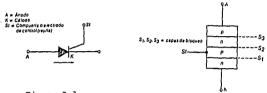


Figura 3.1

La compuerta es e1 electrodo de control del dispositivo. Cuando la polarización es directa, el potencial del Anodo debe ser positivo con respecto al cátodo. Durante el funcionamiento normal el RCS se enciende aplicando una tensión ·oositiva al electrodo de compuerta. El BCS permanece entences cuando la tensión de compuerta se elimine o se haga negativa, hasta que la tensión del cátodo se reduzca a valor inferior al necesario para mantener la corriente de regeneración o directa. Es posible conseguir un rápido invirtiendo la polarización de corriente directa. Como se muestra en la figura 3.2 la estructura básica FNPN de un RCS es analoga a un par de transistores bipolares NPN y PNP.

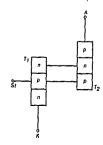


Figura 3.2

Para simular el funcionamiento normal del RCS, el modelo de dos transistores se conecta como la muestra la figura 3.3.

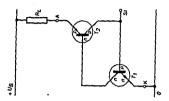


Figura 3.3

El emisor del transistor PNP. Q1 esta retornado terminal positivo de una fuente de CC. A través de una resistencia limitadora RL, mientras que е1 transistor NPN. Q2 esta retornado al terminal negativo de la fuente CC para proporcionar un camino eléctrico completo. modelo esto en estado de no conducción aunque polarizado directamente, permanece bloqueo en estado de presentando una elevada impedancia.

Si se tiene entences un pulso positivo a la hase del transitor NPN, Q2 este se enciende y obliga al colector a reducir su potencial y como resultado de ello comienza a circular una corriente IA. En razón de que el transitor PNP, Q1 esta en estado activo, su corriente de colector circular hacia la base del transistor NPN y fija las condiciones de regeneración por la que la corriente IA seguira circulando incluso después deque desaparezca el impulso de entrada.

Teorícamente el modelo de la figura 3.3 permanece en estado de conducción hasta que la circulación de la corriente principal IA se reduce a cero. En realidad el apagado se produce en algun valor de corriente superior a cero ya que a medida que la corriente principal se reduce gradualmente hasta cero, la división de corrientes dentro del modelo ya no puede mantener la regeneración necesaria y el modelo pasa al estado de bloqueo.

CURVA CARACTERISTICA DEL ROS

La curva característica de tensión vs. corriente de RCS indica que estos dispositivos son ideales para conmutación de potencia. Cuando la tensión existente a través de los terminales princilpales de este tipo de tíristor esta por debajo del punto de ruptura, la corriente que atraviesa el dispositivo es muy pequeña y el tirisor se comporta como interruptor abierto. Cuando la tensión entre las principales aumenta hasta un valor superior al ruptura, el tiristor pasa a su estado de alta conducción y es efectivamente un interruptor cerrado. El tiristor permanecera en este estado hasta que la corriente que pasa por las principales disminuya por debajo de un valor denominado corriente de mantenimiento. En este punto tiristor volvera al estado de alta impedancia.

La figura 3.4 muestra la curva característica princiapal de tensión-corriente de un RCS.

Si observamos la curva nos daremos cuenta que un RCS en condiciones de polarización inversa (Anodo negativo con repecto al Cátodo) se comporta de manera muy similar a la de los rectificadores de silicio polarizados inversamente.

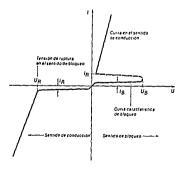
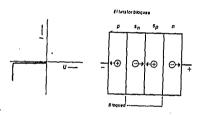
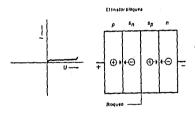


Figura 3.4 Curva característica del tiristor: $I_R = \text{corriente residual en el sentido de bloqueo;}$ $I_B = \text{corriente positiva de bloqueo en el sentido de control;} U_B = \text{tension de conmutación con corriente de control nuils;} I_R = \text{corriente de retención;} I = \text{corriente en el sentido de conducción.}$

El RCS exhibe un alta impedancia interna y a través de la estructura FNPN solo puede circular una pequeña cantidad de corriente inversa. Esta corriente es muy reducida, hasta que la tensión inversa exceda la tensión de ruptura inversa. Despues de este punto la corriente inversa aumenta rapídamente (fig 3.5).

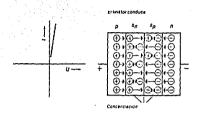


Si polarizamos el RCS directamente (ánodo positivo con respecto al cátodo), su estructura FNPN es electricamente biestable y pueden mostrar o impedancia muy alta (estado de bloqueo directo) o una impedancia muy baja (estado de conduccion). Fig. 3.6.



En el estado de bloqueo directo circula a través del RCS una pequeña corriente directa, el valor absoluto de esta corriente es aproximadamente el mismo que el de la corriente de bloqueo inverso que circula en condiciones de polarización inversa. Cuando aumenta la polarización directa, se llega a un nivel de tensión en el cuál la corriente aumenta rápidamente y

el RCS pasa al estado de conducción. Este valor de tensión se le denomina tensión de ruptura directa (fig 3.7).



Cuando un RCS esta en estado do conducción la corriente directa es limitada principalmente por la impedancia del circuito externo.

CURVAS CARACTERISTICAS DE COMPUERTA

Los RCS estan proyectados especificamente para ser disparados por una señol aplicada a la terminal de compuerta. Esta señal en la compuerta varia o controla la tensión de ruptura del tiristor (fig. 3.8).

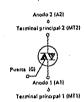


Figura 246. Curvas que muestran las curvas de ruptura de un tiristor para dilerentes valores de corriente de combuerta.

Cuando la corriente de compuerta IG es cero, el tiristor no se ceba hasta que se alcanza la tensión de ruptura directa. Sin embargo a medida que aumenta la corriente de compuerta ID, disminuye el valor de la tensión de disparo del tirisor, existiendo un cierto valor de corriente de puerta IG en el cual el comportamiento del tiristor se asemejo mucho au de un rectificador.

TRIAC

Un TRIAC es un dispositivo bidireccional que funciona principalmente con CA, proyectado para proporcionar conmutación bilateral en cualquiera de las polaridades de la tensión aplicada. Los tres electrodos de este dispositivo PNPN se denominan terminal princial 1, terminal principal 2 y compuerta (Fia 3.9).



La compuerta esta proyectada de tal manera que una tensión negativa o positiva de puerta pueda hacer conducir al TRIAC, cualquiera que sea la polaridad de tensión que haya o través de las terminales principales. Al igual que un RCS el TRIAC una vez puesto en estado de conducción, la compuerta no se ejerce ningún control, el dispositivo permanece asi hasta que la tensión existente a través de los terminales principales se reduzca por debajo del nivel requerido para mantener la conducción. Sin embargo a diferencia del RCS el TRIAC no puede apagarse invirtiendo la polaridad de la tensión que hay a través de los terminales principales, una inversión de tensión solo ocasionaría que la corriente que circula por el dispositivo cambiara de dirección (sentido inverso).

En los TRIACS, la polaridad de los pulsos de disparo de compuerta se mide generalmente con respecto a la terminal principal 1. El TRIAC puede dispararse mediante un pulso de disparo de compuerta positivo o negativo con respecto al terminalrincipal 1 cuando el terminal principal 2 es positivo o

negativo. Por lo tanto el TRIAC se dispara en cualquiera de los cuatro modos de funcionamiento resumidos a continuación en la figura 3.10. Tabla 3.10 — Modos de disparo de los trinos

Tensión entre terminal principal N° 2 y terminal principal N° 1	Tensión entre compuerte y terminal principal N° 1	Cuadran de funciona miento*	
Positiva	Positive ·	1 (+)	
Positiva	Negativa	1 (-)	
Negativs	Pasitive	111 (+)	
Negative	Negative	III (-)	

Los signos positivo (+) y negativo (-) indican la polaridad del pulso de disparo de compuerta.

El modo I(+) es comparable con el funcionamiento de un RCS equivalente, es generalmente el más sensible, ya que requiere menor corriente de puerta. Los otros tres modos de funcionamiento necesitan corriente de disparo de compuerta ligeramente superiores.

CURVA CARACTERISTICA

La curva característica tensión-corriente de un TRIAC exhibe el estado de bloqueo directo y conducción directa de una estructura PNPN, cualquiera que sea el sentido de la tensión aplicada. Esta capacidad de conmutación bidireccional se debe a que un TRIAC se compone escencialmente de dos dispositivos PNPN orientados en forma opuesta y contruidos en el mismo cristal. Por lo consiguiente el dispositivo funciona como dos RCS conectados en paralelo pero con el anodo y catodo de un RCS conectado al cátodo y al ánodo, respectivamente de otro RCS.

características La figura 3.11 muestra que las curvas del funcionamiento del TRIAC en los cuadrantes primero y con .excepción sentido son iquales. del de 1a circulación de la corriente y la polaridad de la tension aplicada.

Las curvas del TRIAC en estos cuadrantes son escencialmente idénticas a las de un RCS que funciona en el primer cuadrante, Pebido a la construcción simetrica del TRIAC ina terminos directo e inverso no se emplean.

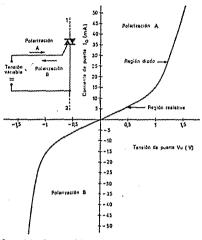


Figura 3.11-Caracteristice de puerta del triac con polarización directa (zona A) o inversa (zona B), manteniendo los electrodos principales en circuito abierto.

PRACTICA 5 RECTIFICADOR CONTROLADO DE SILICIO

na afgagaggi dha girig pengenila (sen bagiri at a 17

OBJETIVO:

- A.- Identificar las tres terminales de un rectificador controlado de silicio (RCS) utilizando un obmetro.
- B.- Mostrar la operación del RCS Y medir la corriente de mantenimiento.

INFORMACION INTRODUCTORIA

El rectificador controlado de silicio es un interruptor de estado solido de 3 electrodos que se utiliza primordialmente para el control de energía de CA y CD. El RCS tiene 4 capas de material semiconductor dispuestas en una estructura PNPN. Las terminales Anodo y Cátodo se conectan a las capas externas P y N respectivamente. La terminal de compuerta se conecta a la capa P interna y sirve para disparar al RCS al estado de conducción.

El RCS funciona como 2 transistores bipolares uno FNP y el otro NPN, conectados en forma cruzada de colector a base para formar un par de retroalimentación regeneradora. Para disparar el RCS y pasarlo al estado de conducción se debe aplicar una tensión positiva entre la compuerta y el cátodo, como el circuito es regenerativo ya no se necesita ol disparo de compuerta y el RCS puede seguir en conducción sin el. Otra forma de poner en conducción el RCS es aumentando el voltaje directo o inverso entre ánodo y cátodo, el RCS entra en ruptura y conduce sin importar cual sea el potencial de la compuerta.

El disparo de compuerta reduce el voltaje directo de ruptura, hasta el punto que el RCS se comporta como rectificador. Cuando fluye la corriente directa se requiere de un valor de corriente minimo de retención, para mantener la conducción entre ánodo y cátodo. En caso contrario el RCS se apaga automaticamente.

El RCS no se puede apagar cortando el voltaje de compuerta ni aplicando un disparo negativo a la misma.

EQUIPO Y MATERIALES

- FUENTE D	E ALIMENTACION	EMS082.
- MODULO D	E MEDICION CD	EMS841:
- MULTIMET	RO ANALOGICO	
- Q1	RCS	C106B1
- 81		4.7 K
- R2		1 K
- R3	POT	10 K
- R4		47 K
~ R5		1 M

- TABLERO DE INSTRUMENTOS

PROCEDIMIENTO

- Consulte un manual de semiconductores e identifique las terminales de ánodo, cátodo y compuerta del RCS C10681
 - b) Ajuste el multimetro analogico a la función de obmetro en el rango \times 100
 - c) Conecte la punta comun (-) al cátodo del RCS y la punta de ohms (+) a la compuerta con éstas conexiones la unión PN de la compuerta cátodo esta polarizada directamente, anote la resistencia.

Rak = -----Ohms

 d) Invierta las puntas del ohmetro y anote la resistencia inversa

RKq = ---- Ohms

e) Mantenga conectada la punta común en la compuerta y

pase la punta de chms al ánodo. Anote la resistencia

Rag= ----- Ohms

f) Invierta las puntas del ohmetro y mida la resistencia inversa de ánodo y compuerta

Rga=---- Ohms

Gonservando la punta común conectada al ánodo pase la punta (+) al cátodo. Registre la resistencia

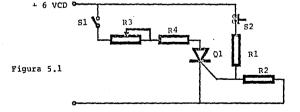
Rka = ----- Ohms

f) Invierta las puntas del ohmetro y anote la resistencia.

Rak = ---- Ohms

 Manteniendo las puntas del ohmetro como en el procedimiento anterior (h) conecte la resistencia R5 entre ánodo y compuerta. Explique que sucede.

 Conecte el circuito de la figura 5.1 mantenga abierto el interruptor SI y ajuste la resistencia R3 para su valor de resistencia minima.



b) Ajuste inicialmente los rangos de los medidores a 15 Vcd y 150 mAcd, la fuente de alimentación mantengala en 6 Vcd. Cierre el interruptor S1 y mida la tensión ánodo a tierra del RCS.

	V = ~~~~~~~~~~~~~Volts
c)	그는 사람들은 이번 사람들이 살아 가는 사람은 사람이 하는 것이다.
	La caída a través de un RCS en conducción tienda apróximadamente el mismo valor que cualquier unión PN de silicio. Aunque S2 esta liberado el RCS sigue conduciendo, sin importar que la tensión de compuerta secero.
d)	Abra el interruptor de S1 momentaneamente y cierrelo de nuevo. Que tensión marca el voltimetro?. El RCS estapagado o encendido?.
	V = Volts
	Una manera de apagar el RCS es desconectar la tensión de fuente de ánodo y cátodo o reducirla pod debajo del valor que se requiere para mantener la corriente minima de retención.
e)	Oprima momentaneamente S2 para encender de nuevo el RCS y aumente l'entamente la resistencia de R3, La corriente de ánodo Ia, empieza a disminuir; ajuste de nuevo el rango del medidor de Ed para poder seguir la lectura de Ia (corriente de ánodo). Describa lo que sucede:
f)	Anote el valor de la corriente de ánodo la, justo antes de que caiga a cero.
	Tola m m/A

valor de corriente y

Cómo se le conoce a este

to a	

FRUEBA DE CONOCIMIENTOS

- 1.- : Qué características de conducción tiene un RCS?
- 2.- Cómo se ceba un RCS?. Explique varias formas.
- 3.- Cómo se deceba un RCS? Explique varias formas.

PRACTICA 6
RECTIFICADOR
CONTROLADO
DE SILICIO
ACTIVADO CON LUZ

OFWETIVO:

A.- Mostrar el funcionamiento de un rectificador controlado de silicio activado con 10z, analizando sus dos modos de disparo.

INFORMACION INTRODUCTORIA

Fara disparar un RCS se inyecta una corriente en la base de los transistores que lo componen (Compuerta), lo que produce su saturación. La exposición del elemento a la láz puede equivale a una coriente de compuerta, ya que la iluminación crea pares electrón-hueco que al ser inyectados en la base del transistor considerado en forma de protadores mayoritarios, crean una corriente de base.

Los rectificadores controlados activados con lúz se fabrican principalmente con materiales semiconductores como Germanio y Silicio. Su sensibilidad luminosa se basa en el efecto fotoeléctrico que se produce en ellos, en el cuál la capa semiconductora modifica el valor de su resistencia en el sentido de bloqueo. Su valor dependera de la intensidad luminosa incidente.

Las estructuras de estos tiristores son muy sensibles, por lo que las corrientes de disparo son del orden de microamperes..

El electrodo o compuerta aparte de poner en conducción el LASCRS sin necesidad de lúz presenta la ventaja de permitir el gobierno de la sensibilidad del dispositivo. El LASCR o fototiristor es entonces un elemento conmutable por lúz que posec dos estados estables y ádemas conserva las características de un RCS

común al no estar expuesto a la lúz.

EQUIPO Y MATERIAL

- FUENTE DE ALIME	NTACION	EMS8821
- OSCILOSCOPIO		
- Q1	LASCR	L8
- R1		22 K
- R2		56 K
- L1	LAMP	1 6.5 V

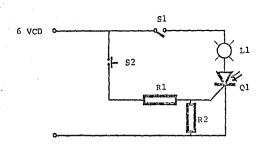
- TABLERO DE INSTRUMENTOS

PROCEDIMIENTO

El circuito de la figura 6.1 mostrara la operación de 1. (1) LASCR un rectificador controlado de silicio activado con laz. Su funcionomiento es idéntifico el de un BCS común. ۸1 e 1 interruptor 51 cerrar ν momentaneamente S2 se aplica un disparo a la compuerta de RCS a través del divisor de tensión R1-R2 . El RCS se dispara y conduce energía a la carga. El LASCR presenta otro modo de disparo ya que puede ser activado sin necesidad de corriente de puerta, solo COR polarizodo directamente y ser expuesto a la láz.Esto provoca que el LASCR se active y conduzca energia a la lampara. La resistencia alrededor de la juntura P-N de compuerta-catodo controla la sensibilidad del del LASCR al estar expuesto a la lúz.

El LASCR se apagará cuando la corriente de ánodo a cátodo caíga a un valor menor que el de la coriente de mantenimiento. A diferencia de los RCS la corriente de mantenimiento es mucho menor, del orden de microamperes. Conecte el circuito de la figura 4.1.

b) Ajuste la fuente de alimentación a 6 Vcd. Mantenga el LASCR cubierto para evitar que este expuesto a la lúz. Cierre S1 y oprima S2 momentaneamente.



E1 LASCR	conduce c	orriente	a 1a	lámparo?		Se
comporta	como un	RCS7			C	6110
apagaria	el LASCR?				- Vbadaejo	•

- c) Abra el interruptor Si. Al interrumpir la corriente de ánodo a cátodo el LASCR se debe de apagar.
- d) Descubra el LASCR y permita que le de la láz.

Enciende	1 a	14	աթու	'a? _						sí	10
vuelve	a	c	ubri	r	dine	Suce	de?				La
incidenc:	ia (de.	lúz	sobr	e el	LASCR	sust	ituye	e1	disparo	de
compuerto	37										

PRUEBA DE CONOCIMIENTOS

- 1.- Explique el efecto fotoeléctrico en el LASCR?
- 2.- Menciome aplicaciones del LASCR?

PRACTICA Z CONTROL DE POTENCIA DE CD POR RCS

OBJETIVO:

- A.- Hostrar que un RCS opera como interruptor semiconductor utilizandolo para controlar un voltaje de CD aplicado a una carga.
- B.- Mostrar que un RCS disparado puede funcionar como un rectificador de media onda y que puede controlar la aplicación de tensión rectificada a la carga.

INFORMACION INTRODUCTORIA

El RCS está diseñado para funcionar como un dispositivo de control de energía. Una pequeña corriente de compuerta puede controlar un voltaje o corriente mucho mayor en el circuito óquodo-cátodo. Se pueden utilizar diversos métodos para disparar la compuerta por ejemplo, la señal de compuerta puede ser CA, CD, un pulso o puede ser una señal relacionada en fase con la carga. De la misma manera el RCS puede controlar diversas condiciones de carga. La carga puede ser una simple lámpara o un motor industrial. También puede ser necesario que se utilize simultaneamente al RCS como rectificador y como dispositivo de control. Resumiendo para su tamaño y costo el RCS es un dispositivo unico en las aplicaciones de control de potencia.

-	FUENTE DE ALIMENTA	ACION	EMS	0821
-	MULTIMETRO ANALOGI	co .		
	VARIAC			
-	01	RCS	C10	611
-	Ri		4.7	K
-	R2		1	К

150 mA

TABLERO DE INSTRUMENTOS

PERCENTAMENTA

LAMPARA

1.- a) Conecte el circuito de la figura 7.1, el interruptor S2 se utiliza para aplicar voltaje de anodo a cátodo. El interruptor SI se utiliza en combinación con el divisor de Voltaje R1/R2 para aplicar un disparo de compuerta al RCS Q1.

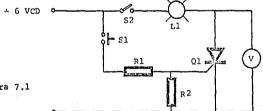


Figura 7.1

La resistencia R2 sirve también para conducir corriente "de fuga de compuerta, alrededor de la unión FN de compuerto-cátodo. Esta reduce la posibilidad un disparo en falso del RCS.

Ajuste la fuente de alimentación a 6 Vcd, cierre ь) imterruptor 92 y oprima momentaneamente 81.

Enciende	1 a	1dmpara	ľ			
Se anaga	1 a	lámpara	a1	soltar	91?	

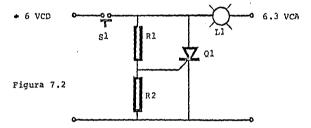
For	qué?	

c) - Es mayor la tensión en el RCS o en la lómpara?

La corriente de carga y ánodo es la misma?

Podemos observar que el RCS funciona como interruptor de control, con un gasto de potencia minima.

- d) Abra el interruptor S2 y apague la fuente de alimentación .
- 2. a) Examine el circuito de las figura 7.2. La fuente de alimentación nos proporcionara la tensión en CD 6 Vcd y el VARIAC la tensión alterna 6.3 Vca. Conecte como muestra la siguiente figura.



El RCS conducira cuándo se oprima el interruptor S1. Una vez disporado conduce en cada ciclo positivo del voltaje ánodo-cátodo, en la alternación negativa el RCS esta polarizado inversamente y se apaga a menos que se mantenga activado el circuito de disparo.

 h) Ajuste el voltaje ánodo-cátodo con el VARIAC a 6.3 Vca,
 y la fuente de alimentación a 6 Vcd oprima y mantenga el interruptor S1.

26	GUC:	rende	2 10	1	rdup	La.	r			
Lil	ere	Si.	Se	ma	ntie	ne	encendida	la	14mpar	ን የ
F3	RCS	func	ior	20	cono	rı	ectificador	· de	media	nndo'

d) En cuántos pulsos por periodo se entrega potencia a la carga?

En tanto se aplique un voltaje de disparo el RCS conduce durante el semiciclo positivo y se comporta como rectificador de media onda, controlando la aplicación de voltaje rectificado a la carga.

PRUEDA DE CONOCIMIENTOS

- 1.- Qué puede provocar la corriente de fuga de compuerta?
- 2.- El voltaje de disparo del RCS con relación al cátodo debe ser?

PRACTICA 8
CONTROL DE FASE
POR RESISTENCIA
VARIABLE

OBJETIVOS :

A.- Mostrar la operación de un circuito de media onda de control de fase por resistencia variable.

INFORMACION INTRODUCTORIA

Control de fase significa controlar la fase del disparo con respecto a la del voltaje de ánodo, limitando con ello el tiempo de conducción del RCS. Así la potencia que se entrega a una carga se puede controlar variando el ángulo de conducción de un RCS. El ángulo de conducción es el tiempo en grados eléctricos que conduce el RCS y entrega potencia a la carga.

Como las características de la caraa en aplicaciones de control de potencia de CA pueden ser tales que no se requiera potencia de entrada en forma continua. Un gulso de voltaje o corriente entregado a la carna periodicamente, reduce la potencia, promedio que basta para desarollar toda la potencia necesaria. Al controlar de manera efectiva los pulsos periodicos. nuede satisfacer los requerimientos de potencia de la caraa y al mismo tiempo evitar disipación innecesaría. Si se suministran los voltajes de compuerta y de carga desde la misma fuente de CA, se puede ajustar el tiempo de conducción del RCS en el ciclo positivo controlando la amplitud relativa del voltaje de disparo de compuerta con respecto al voltaje de carga. Por lo general, el voltaje de disparo se ajusta de manera que se pueda variar el ángulo de conducción para satisfacer los requerimientos de la carga.

COUTED STEETS ALDES

- FUENTE DE ALIR	MENTACION	EMS0021
- MODULO DE MEDI	CCION CA	EMS8424
- MULTIMETRO AND	/LOGICO	
- OSCILOSCOPIO		
- 01	RCS	C106B1
- R1		1 K
- R2	F:OT	50 K
- R3		100 K
- pi	DIODO DE SI	1N4004
- L1	LAMP	6.5 V

PROCEDIMIENTO:

- TABLERO DE INSTRUMENTOS

1. 0) analice el circuito de la figura 8.1 al cerrar interruptor S1 se aplican 6.3 Vca entre anodo y cátodo del RCS, pero la lámbara permanecera anagada en tanto RCS no se dispare.

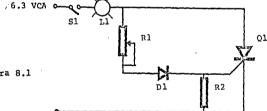


Figura 8.1

RI controla la amplitud de la tensión de disparo tanto, controla el tiempo de conducción de Qi. El disparo ocurrira en el semiciclo positivo, el automaticamente en el semiciclo negativo. función del diodo DI es impedir que haya una en compuerta, en los periodos negativos de la onda de alimentación.

b)	Conect	e el ci	cuito	์ AJus	to la	resi	sten	cia	RI	a	511
	valor m	inimo,	encier	nda 1.	ı fuer	ite di	is is	limen	taci	бn	У
	mantenga	la tens	sión er	6.3	Joa. Ci	ierre (el i	nterr	արեշ	r S	1,
	la lampa	ra debe	de enc	ender	. Utili	ice el	050	ilosc	opic	pa	ra
	observar	la form	na de c	onda (le ten	sión	a	travé	s d	6	Гa
	lámpara.	arafinu	ela.								

- Aumente lentamente la resistencia de R1 y describa lo que sucede a la media onda senoidal.
- d) El ángulo de conducción es el tiempo que el RCS conduce medido en grados eléctricos, Registre los ángulos de conducción máximo y mínimo de Q1.

VMGATO	MAX	æ	grados	ANGULO	MIN	E	grados
--------	-----	---	--------	--------	-----	---	--------

e) El retraso de disparo que introduce Ri respecto al voltaje de ánodo se conoce como retraso de fase y se expresa también en grados eléctricos. Registre los valores mínimos y máximos de retraso de fase.

grado	OMINING	FASE	DE	RETRASO
grada	MAXIMO	FASE	BΕ	RETRASO

f) Si controlamos la fase con una resistencia variable, se puede retardar la fase del disparo de compuerta desde cero a 90 grados con respecto a la tension del ánodo. Apaque la fuente.

PRUEBA DE CONOCIMIENTOS

- 1.- Cómo controla R1 el retraso de fase en este circuito?
- 2.- Porqué B1 no puede retrasar la fase más de 90 grados?
- 3.- Controla R1 la potencia que se entrega a la carga?

PRACTICA 9 CONTROL DE FASE POR RED RC

OFLIETTVO

Nostrar la operación de un circuito de media onda de control de fase por diodo y red RC

INFORMACION INTRODUCTORIA

El metado más simple para mejorar el circuito de control de puerta de la práctica anterior, es adicionando un condensador en el extremo inferior de la resistencia de la compuerta (fig. 9.1).

La ventaja de este circuito es que el angulo de disparo se puede ajustar a mas de 90 grados, porque el condensador el cargarse a traves de R, retarda el momento en que se alcanza la tensión de cebado. A continuación se explicara brevemente la operación de un circuito de retardo en el disparo usando una red RC.

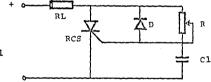


Figura 9.1

Este experimento viene a demostrar que una red RC logra un retraso de fase en mayor angulo. El voltaje a través del capacitor es el del disparo, la cantidad y velocidad para cargarse se determinan por la constante de tiempo RC. Cuando R presenta su valor de resistencia minima, el condensador se carga cuando la tensión de ánodo del RCS comienza a hacerse positiva, lo que ocasiona que el RCS se dispare de inmediato Cuando R presenta una máxima resistencia, el condensador se carga lentamente de manora tal que este jamás obticne

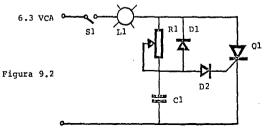
suficiente carga para disparar el RCS, antes de que la polaridad se invierta y se descargue. En consecuencia para una máxima resistencia el RCS siempre estará apagado.

EQUIPO Y MATERIAL

- FUENTE DE	ALIMENTACION	EMS8821
- MULTIMETRO	ANALOGICO	
- OSCILOSCOP	10	
- Q1	RCS	C106B1
- C1		0.22 MF
- R1	FOT	50 K
- p1	DIODO DE SI	1N4004
- D2	biodo de si	1N4004
- L1	LAMP	6.5 V
- TABLERO DE	INSTRUMENTOS	

PROCEDIMIENTO

1. a) Conecte el circuito que muestra la figura 9.2. El disparo de compuerta se controla con la constante de tiempo RC de R1 y C1. C1 se carga durante el medio ciclo positivo y se dascarga en el medio ciclo negativo a través del diodo D2, quedando listo para el siguiente ciclo de carga. Con este circuito se puede variar el retraso de fase en mayor ángulo que usando una resistencia variable.



- b) Prenda la fuente de alimentación y ajustela a 6.3 Vca, ajuste Ri para mínima resistencia del circuito de dispara y cierre el interruptor C1. Enciende la lámpara?
- c) Conecte el osciloscopio y observe la curva de tensión a través de la lámpara. Dibujela y registre el angulo de conducción máxima.

ANGULO MAX = _____grados

 d) Aumente lentamente la resistencia R1 hasta el máximo mientras observa el osciloscopio, registre el ángulo mínimo de conducción

ANGULO MIN = _____grados

e) Apague la fuente

FRUEBA DE CONOCIMIENTOS

- 1.- Cúales son los valores minimo y máximo de retraso de fase?
- 2.- Por qué este circuita da mayor control del rango del retraso de fase que el circuito anterior?

PRACTICA 10 CIRCUITO DE MEDIA ONDA DE CONTROL DE FASE FOR RCZSUS

OBJETIVO:

A.- Mostrar la operación de un circuito de control de fase que útiliza RCS-SUS

INFORMACION INTRODUCTORIA

Aunque los circuitos de control de puerta utilizan una red RC para el retardo del disparo presentan la ventaja de que el ángulo de disparo puede ajustarse la más de 90 grados. Su operación se ve afectada por dos ·características que se pueden considerar desventajas y que presentan todos los RCS; estas son; la variación del valor de coriente necesaria para disparar dependiendo de la temperatura, y las desviaciones en las corocterísticos eléctricos de los RCS con respecto al gruno que pertenecen. Apalizando los dos desventajos notaremos que para un cambio de temperatura se producir un cambio en el ángulo de disparo del RCS y de hecho un cambio en la corriente de carda, y que dos de un mismo tipo pueden tener diferencias grandes en sus características. La variación de la corriente de puerta es la diferencia más seria.

La figura 10.1 muestra como nueden eliminarse dificultades. Este circuito utililiza un SUS estas (Interruptor unilateral de silicio) que presenta 105 ventajas de su indepencia de la temperatura y de una dispersión de grupo muy estable que logra que la tensión de disparo pueda mantenerse consistente en todas las unidades del mismo tipo. El SUS tiene cierto voltaje de disparo en el sentido directo (ruptura positiva). Si la tensión aplicada al anodo esta por debajo del punto de disparo, el SUS actúa como interruptor abierto, cuando la tensión alcanza la tensión de ruptura el SUS conduce produciendo una inyección instántanea de corriente que se puede utilizar para el cebado seguro de un RCS o un TRIAC.

El SUS tiene una términal de puerta , la cuál puede alterar el funcionamiento básico de disparo. Conectando un diodo zener entre puerta y catodo del SUS la tensión de disparo puede roducirse a la tensión zener sumada a la tensión de la juntura FN interna.

CHCGG71

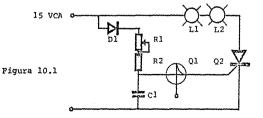
EQUIPO Y MATERIALES

- LOCALE DE UETA	THILLIAM	EMOODE:
- OSCILOSCOPIO	•	
- MULTIMETRO ANAI	rocico	
- 01	sus	2N49B7
- 02	TRIAC	SC106B
- R1		4.7 K
- R2	F'OT	10 K
- L1,L2		6.5 V
- C1		.22 AF

⁻ TABLERO DE INSTRUMENTOS

PROCEDMIENTO

a) Conecte el circuito de la figura 10.1.



El condensador C1 se carga a través de las resistencias R1 y R2 cuíndo alcanza la tensión de ruptura

del SUS este se dispara, conduciendo un pulso de corriente a la puerta de el RCS ocasionando que este se "encienda" y conduzca energia a la carga , la resistencia variable R2 se útiliza para cambiar el duqulo de disparo, ya que varía el tiempo de carga del capacitor C1 ocasionando que la tensión de ruptura del SUS se alcance mas rápida o lentamente.

b) Ajuste la fuente de alimentación a 15 Vca y la resistencia R2 a su valor máximo. Cierre el interruptor S1 y aumente lentamente el valor de resistencia en R2. Observe lo que sucede.

Enciende	la	1dmpara?	
----------	----	----------	--

c) Conecte el osciloscopio y observe la onda de tensión en la carga, grafique la curva para el mínimo ángulo de conducción (resistencia mínima) y para el mánimo ángulo de conducción (resistencia minima).

d) Conecte el osciloscopio entre el anodo del SUS y tierra, observe la curva de tensión y explique por que esta cae rapidamente a un valor mínimo.

PRUEBA DE CONOCIMIENTOS

- 1.- Cuántas términales tiene un SUS. Para que se átiliza la terminal de compuerta?
- 2.- Qué diferencia hay entre un SUS y un SBS?

PRACTICA 11 TRANSISTOR DE UNIJUNTURA (UJT)

SOVITACAC

- A.- Medir la resistencia entre las bases y determinar las características de la unión PN entre el emisor y la base 1 de un UJT.
- B.- Determinar la relación intrínseca de mantenimiento de un U.T.
- C.- Medir tensión máxima de disparo del emisor de un transistor de unijuntura.

INFORMACION INTRODUCTORIA

El transistor de unijuntura UJT, como su nombre la indica, poseé sálo una juntura PN semejante a un rectificador. Sín embargo difiere del diodo en que el material N es una pieza de silicio con un contacto obmico a cada extremo. Estos dos contactos se conocen como base 1 y base 2. La terminal que sale del material P se conoce como emisor. Fig. 11.1.

Rb1 y Rb2 representan la resistencia ohmica de la pieza de silicio entre la base 1 y la base 2, la resistencia total entre las bases es Rbb. Cuando se aplica una tensión Vbb entre las bases, fluye corriente a través de Rbb y se establece una caída gradual de tensión, lo que hace que el punto de la unión con la juntura PN este mas positivo que B1.

Como no hay tensión aplicada al emisor, la juntura PN esta polarizada inversamente. Para que el UJT funcione como transistor es necesario aplicar una tensión positiva a la términal de emisor. Pero esta tesión debe ser suficiente para vencer la polarización inversa provocada por la caída de tensión en Rbi y así lograr que

circule una corriente de emisor hacia la base 1.

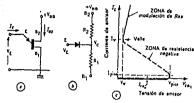


Figura 11.1 Polarización del UIT (a), esquema equivalente (b) y curva característica de emiaor (c).

Esta tensión máxima de de disparo de emisor es una función de tensión de la fuente Vbb, la caída del diodo. Vd y de la relación intríseca de mantenimeinto η_{\star}

La relación intrínseca de mantenimeinto se refiere a la relación de divisor de tensión de la resistencia de base (Rb).

Una característica única del UJT es que, al alcanzar la tensión máxima de disparo en el emisor la resistencia Rbl disminuye, por lo que se dice que cuando dispara el UJT, el emisor exhibe resistencia negativa.

MATERIALES Y EQUIPO

-TABLERO DE EXPERIMETOS

-FUENTE DE ALIMENTA	EMS8821		
_MULTIMETRO ANALOGI	CO		
-01	TLU	2N2646	
-R1		10 K	
-R2		100k	
-R3		1 K	
-R4	Pot.	10 K	
-C1		.022 AF	
-C2		.01 <i>∤</i> (F	

PROCEDIMIENTO

1.a) Utilice un manual de semiconductores e idéntifique las términales del UJT. Fije la función de Ohmetro en el multimetro analógico en el rango x1K.

ermente de la companya del companya de la companya del companya de la companya del la companya de la companya d

b) Mida y registre la resistencia entre la base 1 y la base 2, invierta las puntas del ohmetro y mida de nuevo.

Rbbo=____K

Las mediciones iguales de resistencia de base indican que el UJT conduce corriente en ambos sentidos.

Conecte la punta de ohms (+) en el emisor y la de comun
 (-) en la base 1, anote la medición del ohmetro.

Rbe1=_____K

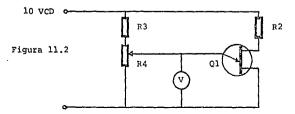
Esta es la resitencia directa de emisor a base 1. Ester valor será siempre menor a Rbbo e incluye la resistencia directa del diodo.

d) Invierta las puntas del ohmetro y mida la resistencia inversa entre emisor y base 1.

Rbe1=____K

Los valores obtenidos revelan que entre el emisor y la base 1 existe una juntura PN.

2.a) Conecte el circuito que muestra la fig. 11.2 cuidando de ajustar R4 a su mínimo valor de resistencia.



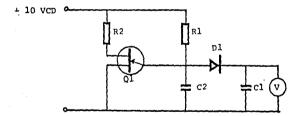
b) Ajuste la tensión de la fuente Vbb a 10 V cd. A continuación aumente la resistencia R4 y con el voltímetro contestado como en la figura, observe y describa que sucede con la tensión de emisor a tierra.

c)	Auß	renresenta	10	lecture	mávima	en	αì	voltímetro?

 d) Repita el procedimiento si es necesario y anote el valor máximo de disparo.

Vp= vo	11	t.		5
--------	----	----	--	---

3.a) En este experimento trataremos de determinar la , relación intrínseca de mantenimiento de un UJT a partir de la ecuación para la tensión máxima de disparo: Vp= n*Vb + Vd



La función de C2 es cargarse a través de R1 hasta alcanzar la tensión de disparo del UJT. Cuando este se dispara el capacitor se descarga a través del circuito emisor-base 1 del UJT. A1 descargarse C2 no puede mantener la tensión de disparo y el UJT se apaga. La acción se volverá a repetir al siguiente ciclo positivo y asi sucesiyamente.

El capacitor C1 se carga a la par que C2 con la tensión máxima, menos la caida del diodo. Debido al diodo D1, C1 se conserva cargado, en consecuencia; cáda vez que se carga C1 la lectura máxima del voltímetro representa la tensión máxima de disparo Vp. Como el diodo D1 compensa la caída de tensión en la juntura del UJT la ecuación de Vp se reduce a:

Up=n*Vbb

Conociendo Vp y Vbb podemos calcular al relación intrínseca de mantenimiento.

 Ajuste la tensión de la fuente a 10 V cd, mida y anote la tensión múxima a través de C1.

Ec 1 =		volts

 Cálcule la relación de intrínseca de mantenimiento útilizando el valor de Vbb y Eci.

η=Vp/Vbb=Ec1/Vbb	η=

La ventaja de conocer la relación intrínseca n es que sí se conoce Vbb se pude cálcular la tensión de disparo Vp para un UJT dado. Por esta razón casí siempre nos la da el fabricante.

PRUEBA DE CONOCIMIENTOS

- 1.- En el procedimiento 2.-(e) qué provoca la repentina disminución de tensión en el emisor.
- 2.- Qué es la relación intrínseca de mantenimineto?

PRACTICA 12 OSCILADOR DE RELAJACION

DEJETTUO:

- A.~ Mostrar la operación y determinar la frecuencia de un oscilador de relajación con un UJT.
 - B.~ Mostrar el efecto de un cambio de elementos sobre lo frecuencia en un oscilador de relajación.

INFORMACION INTRODUCTORIA

En el experimento anterior vimos como funciona el UJT. Se comprobó que la tensión máxima Vp controla el disparo del UJT; la tensión Vv, que es la tensión a la cuál la juntura PN se polariza nuevamente a la inversa, se le denomina tensión de valle y controla escencialmente el punto en que el UJY se apaga. La constante de tiempo RC del circuito de sincronia determina la frecuencia de un UJT.

Coantrolando adecuadamente Vp y Vv se puede prender y apagar el UJT y variando la R o C se puede cambiar la frecuencia. Lo que es básicamente la manera como se útiliza el UJT en los circuitos de generación de ondas. El más conúm de los circuitos generadores de onda es el oscilador de relajación.

cuconsi

EQUIPO Y MATERIALES

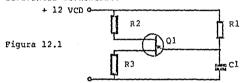
-CHENTS BE ALTHENTACION

-LOENSE DE UES	MENIALIUN	EUSBRSI
-OSCILOSCOPIO		
-MULTIMETRO AN	MLOGICO	
-01		.22 KF
-02	Eléctrolitico	25 AF
-R1		10 K
-R2		1 K

-R3	. 1		47 sz.
-84			100 K
-85			1 M
-01		TLU	202646
-TABLER	D DE EXPER	IMENTOS	

PROCEDIMIENTO

1.a) Conecte el circuito de la fig. 12.1. Es un oscilador de relajación y puede proporcionar endas tipo diente de sierra, pulsos positivos y pulsos negativos en sus diferentes términales.



 Ajuste la tensión de la fuente a 12 V cd. Observe la anda a travós de C1 útilizando el osciloscopio. Grafíguela.

El capacitor C1 se carga a través de R1 hasta alcanzar una tensión igual a la de disparo Vp. En esto punto el UJT se dispara y C1 se descarga a través de R3 y el circuito de base 1-emisor.

Al siguiente semiciclo el condensador comienza a cargarse nuevamente y la acción se repite. La forma de onda de tensión es entonces un diente de sierra.

c) Mida, registre el período y cálcule la frecuencia.

p≈	ims	f=1/T=	11	2

d) Observe con ayuda del osciloscopio la curva de tensión en la resistencia R3. Qué tipo de onda se despliega y cuál es su amolitud?

La corriente de descarga del capacitor produce un máximo de tensión positiva a través de RJ entre la base 1 y tierra.

 e) Repita el procedimiento del inciso d); para la resistencia R2.

Cuando se dispara el UJT la corriente máxima de Dase 2 provoca una caída de tensión en R2 por lo que se produce un máximo de potencial negativo.

 d) Cálcule la frecuencia para el oscilador de relajación dilizando los valores de Rí v Ci.

F=L/Rici	=	112

Coincide con lo obtenido en el procedimiento c)?

La constante RC determina la frecuencia del oscilador de relajación y esta es independiente de cualquier cambio en el circuito que no involucre R1 o C1.

- Observaremos el efecto que produce sobre la frecuencia del oscilador de relajación, el cambio de valor de las componentes de la constante de tiempo RC.
 - b) Remplace en el circuito anterior la resistencia R1 de 10 Ka por la resistencia R4 de 100 K. Prenda de nuevo la fuente y ajustela a 12 Vcd, mida el período del diente de sierra en C1 y c41cule la frecuencia.

T=		seg	ドニナノエ	E	H	2
----	--	-----	-------	---	---	---

Nos daremos cuenta que conforme aumentamos el valor de la resistencia de la constante RC, disminuye la frecuencia de oscilación. El mismo efecto tendremos al aumentar el valor de la capacitancia.

c) Apague la fuente de alimentación, remplace la resistencia R4 por R1 de nuevo y C1 por el capacitor C2 de 25 AF.

Este condesador es eléctrolitico. Asegurese de observar la polaridad apropiada. El extremo positivo de

C2 se conecta al emisor y el extremo negativo a tierra.

d) Ajuste la fuente de la alimentación a 12 Vcd, mida el período diente de sierra a través de C2 y cálcule la frecuencia.

T≕	sea	F=1/T =	Hz

PRUEBA DE CONOCIMIENTOS

- 1.- Una onda senoidal esta disponible en un oscilador de relajación?
- Cuáles son los principales aplicaciones del oscilador de relajación? Mencione 3.
- 3,- Qué influye en la tensión de dispara de un oscilador de relajación?

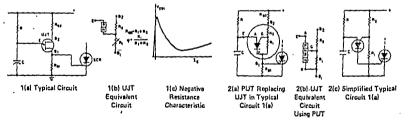
PRACTICA 13 CIRCUITO DE DISPARO UTILIZANDO PUT

OBJETIVO:

A.- Hostrar la operación de un transistor uniunión programable (PUT) en un circuito de disparo para RCS.

INFORMACION INTRODUCTORIA

El transistor de unijuntura programable (PUT) tiene características idénticas de funcionamiento de un UJT común, solo que en el PUT se pueden ajustar los valores de η , I de pico e I de valle. El PUT es un tiristor de 3 terminales que son designadas como ánodo, ánodo-gate y cátodo. Presenta una estructura planar PNPN conectada a la resistencia de las bases como muestra la fig. 13.1.



La fig. 13.c muestra un circuito básico con UJT.

La fig. 13.d muestra el mismo circuito pero se remplaza
por un PUT. Comparando los circuitos equivalentes en las
figuras 13.a y 13.b, se puede observar que ambos
circuitos tienen un diodo conectado a un divisor de
tensión R1-R2, cuando este diodo se polariza directamente
tanto el UJT como el PUT se disparan presentando una
característica unica de resistencia negativa entre el

emisor o ánodo y Rb1 (ver practica 10). Cuando el diodo se polariza directamente circula una corriente de ánodo a gate (fig. 13.a) que sirve para el disparo del PUT. La corriente de ánodo necesaria para el disparo es la corriente de pico Ip y esta es más débil mientras mayores sean las resistencias conectadas al gate. Si la corriente principal de ánodo Is disminuye de determinado valor, la juntura FN entre el gate y el ánodo se polariza inversamente y el PUT se 'apaga', este valor de Ig se conoce como corriente de valle Iv; esta sera tanto mayor cuanto menor sea la resistencia. Las resistencias R1 y R2 en el PUT pueden regular la tensión a la cuál el diodo se polariza directamente.

Después que é1 diodo conduce, la retroalimentación regeneradora en la estructura PNPN (ver gráfica 13.1) ocasiona que el PUT se encienda y dispare, generandose la característica de résistencia negativa de dnodo-gate a cátodo de RbI para un UJT convencional.

El empleo convencional del PUT es en timers, controles de fase de alta ganancia y osciladores de relajación.

EQUIPO Y MATERIAL

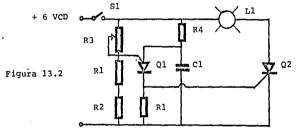
-FUENTE D	E ALIMENTACION	•	EMS8821
-Q1		SCR	C106D1
-02		PUT	2N6027
-R1			4.7 K
-82			4.7 K
-R3			2.2 K
-R4			100 K
-R5			100 A
-C1			,004 AF
-C2	•		.0022 AF
-L1		Limpara	6.5 V

⁻TABLERO DE EXPERIMENTOS

⁻OSCILOSCOPIO

PROCEDIMIENTO

E1 circuito de la fia. 13.2 es un oscilador relajación que útiliza un PUT: R1.R2 R3son las resistencias de programación del PUT. R4 y C1 son las componentes de tiempo para el mísmo. El pulso positivo generado a través de la resistencia R5 de cátodo del PUT dispora el RCS. Varíando el valor de la resistencia de compuerta programamos la I de pico y la ! de valle y cambiando. las componentes de tiempo se pueden variar las características de disparo.



b) Conocte el circuito de la fig. 13.2, ajuste la fuente de poder a 6 V cd y R3 a su valor mínimo de resistencia. Cierre el interruptor Si y observe que pasa.

Funciona el oscilador de relajación?

Obtenga el valor de la resistencia equivalente en la compuerta Rg = ER1*R2/R1+R23 y mida la corriente de valle Iv en el emisor y la corriente de pico o disparo en la compuerta.

Rg=K	Ip= A
I∨¤	mА

Desconecte el interruptor S1.

 Ajuste al máximo de su valor de resistencia R3 y cierre el interruptor S1. Realice de nuevo la operación del

F	Rg=
	Iv=mh
	Qué pasó con el valor de la corriente? Son del mismo valor?
	Con diferentes montajes se puede regular separadamente la Ip y la Iv, lograndose que el FUT puede dispararse con pequeñisimas corrientes y tenga una corriente de mantenimiento de valores considerablemente mayores.
d)	Apague toda.
. a	Conecte el condensador C2 en serie con C1, lo capacitancia equivalente sera mucho menor al valor de C1, con esto la constante de tiempa se vera disminuida. Ajuste R3 a su mínima resistencia. Prendo la fuente de alimentación y cierre el interruptor S1.
	Porqué?
ь>	Concete el oscilosciopio entre la compuerta del RCS y tierra, mida la tensión de pico. V pico=
	Es suficiente para disparar el RCS?
	Que características les falta a los pulsos?
c)	Apague la fuente de alimentación.

PRUEBA DE CONCCEMEENTOS

- 1.- Exponga las diferencias del PUT y del UJT.
- Mencione una manera para programar por separado la Iv y la Ip de un PUT.
- 3.- Al disparar un RCS. Que características debe tener el disparo en la compuerta?

PRACTICA 14

OBJETIVOS

A.~ Mostrar la operación bidireccional de un TRIAC y sus cuatro formas de dispara.

INFORMACION INTRODUCTTORIA

El TRIAC es un interruptor de estado sólido bidireccional de tres terminales. Opera en forma muy semejante a dos RCS conectados a la inversa en paralelo. Como tal puede conducir con cualquier polaridad de tensión entre términales y se puede disparar por cualquiera de las polaridades de la soñal de puerta. Las tres términales se denominan: Términal principal i (MTI), Términal principal2 (MT2), y Fuerta.

El TRIAC tiene la misma propiedad regenerativa interna que el RCS, por lo que se requiere un valor mínimo de corriente de retención Ioh (Corriente de mantenimiento) y valtaje términal para mantener la conducción en cualquiera de las direcciones. El TRIAC tiene cuatro modos posibles de disparos que son (Con respecto a la términal principal 1)

V ₂ +	V ₂ +
V ₆ -	V ₆ +
V ₂ -	V ₂ -
V ₆ -	V ₆ +

CUADRANTE	V ₂	V _{ii}	NOTACION
(· II III IV	> 0 > 0 < 0 < 0	0000 \\\\\\	++ +- -+

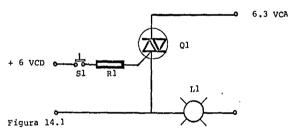
La conducción siempre ocurre en el primer cuadrante cuando MT2 es positivo y en el tercer cuadrante cuando NT2 es negativo.

EQUIPO Y MATERIALES

- FUENTE DE ALIMENTACION	EMS8821
FUENTE DE CD	5-6 V
- OSCILOSCOPIO	
- Q1 TRIAC	SC136B
- R1	47_2_
- L1 LAMP	6.5 V
- TABLEDO DE THETSUNGHTOR	

PROCEDIMIENTO

 a) Conecte el circuito de la figura 14.1, ajuste la tensión entre términales a 6.3 Vca y la de la fuente de compuerta a 6 Vcd.



 Oprima el interruptor S1 y sostengalo asi. Se enciende la lámpara?

Libere Si. Se apaga la lámpara?

Aunque el TRIAC es bidireccional una vez disparado mantiene la conducción solo si el voltaje entre terminales no cambia de polaridad. Ya que si la tensión cambia de polaridad tiene que pasar por un valor de tensión cero y la corriente que circula a través del TRIAC caería a un valor menor que el de la corriente de mantenimiento; apagandose el TRIAC dejando de proporcionar energía a la lámpara.

c) Conecte el osciloscopio a través de la lámpara para observar la curva de tensión de la carga. Oprima el interruptor S1 y retengalo; observe la forma de onda en el osciloscopio. Grafíquela.

-	una	anda	senoidal?	
. 6	una	onaa	senoidai!	

Esto verifica la caracteristica bidireccional del TRIAC, ya que esta conduciendo los 360 grados integros del voltaje entre terminales.

 Al circuito anterior añada el interuptor S2 como lo muestra la figura 12.3 con los procedimientos de este experimento complete la tabla 14.1

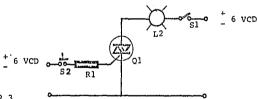


Figura 12.3

- Ajuste los voltajes de terminal y compuerta a 6 Vcd.
- c) Cierre S2 y oprima momentáneamente S1, Enciendo la 14mpara?

. Abra S2 y apague todo,

Registre en la tabla 14.I el modo de disparo del TRIAC

d) Invierta la polaridad de tensión en la compuerta y ajuste el voltaje a menos 6 Vcd. Cierre el interuptor S2

Y	oprima	momentáne	amen1	te		51.	La	Lámpara
enci	ende?		ahra	92	y	apague	todo.	

Registre en la tabla 14.I el modo de disparo del TRIAC

e) Invierta la polaridad de la fuente de alimentación. Ajusto la tensión entre términales a menos 6 Vcd cierre \$2 y oprima momentáneamente \$1. La lámpara debe de encender.

Registre en la tabla 14.1 el modo de disparo del TRIAC

f) Invierta nuevamente la polaridad de la tensión de compuerta cambiandola a 6 Vcd y repita los pasos señalados en los procedimientos anteriores.

Registre en la tabla 14.1 el modo de disparo del TRIAC

PRUEBA DE CONOCIMIENTOS

- 1.- Cudntas junturas PN hay entre la compuerta y la términal principal 1 (MT1) en un TRIAC?
- 2.- Cuántos modos distintos de disparo tiene un TRIAC?
- 3.- Cúal de los modos de disporo es menos útilizado y por qué?

MODO DE DISPARO DEL TRIAC						
CUADRANTE	POLARIDAD DE MT2	POLARIDAD DE VOLTAJE DE COMPUERTA				
i						
ī						
111	·					
111	·					



OBJETIVO:

1.- Mostrar la operación bidireccional de un MAC

INFORMACION INTRODUCTO

El DIAC es un diodo de avalancha hidinge (min) de dos electrodos y tres capas que puede pasarse ddel estado de apagado al de conducción para cualquiera de las polaridades de la tensión aplicada. La figura 15.1 muestra el diagrama de junturas y el simbolo esquematico de un DIAC.



Figura 15.2

Su construcción es similar al de un transistor bipolar, pero difiere de este en que las concentraciones de impurezas entre las junturas son aproximadamento las mismas y en que no hay ningún contacto a la capa bese. Los niveles de impureza somejantes producen una curva característica de conmutacion bidireccional simétrica. (figura 15.2)

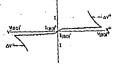


Figura 15.1 curve característica de tensión-co-

Cuando se aplica una mayor tensión negativa o positiva a través de las términales del DIAC, circula a través del dispositivo una corriente (Ibo) mínima, hasta que la tensión llega al punto de ruptura Vbo. La juntura sufre entonces una ruptura de avalancha y más allá de este punto, el dispositivo muestra una característica de resistencia negativa, es decir; la corriente que atraviesa al dispositivo aumenta sustancialmente al disminuir la tensión el pulso de corriente que se produce cuando el BIAC cambia de estado de no conducción al de conducción se útiliza para fines de dispara, La tensión de ruptura del DIAC es simétrica en ambas direcciones.

EQUIPO Y MATERIALES

- TABLERO DE INSTRUMENTOS

- FUENTE DE ALIP	ENTACION	EMS8021
- OSCILOSCOPIO		
- 01	DIAC	872
- C1		0.1 HF
- R1		10 K

PROCEDITATENTO

 a) El circuito de la figura 15.3 es un oscilador de relajación que útiliza un BIAC. El capacitor C1 se carga al valtaje de ruptura del BIAC y entonces este se dispara. La acción se repite sucesivamente. Canecte el circuito.

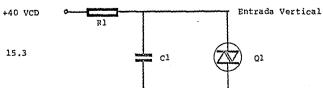


Figura 15.3

- Ajuste la tensión de la fuente de alimentación a 40 Vcd.
- c) Aterrize momentáneamente la entrada vértical del osciloscopio, conectandola como muestra la figura 13.3. Coloque el trazo en la pantalla del esciloscopio en el centro para una referencia a cero volts. Mida la tensión máxima positiva de la onda a través del DIAC.

Esta es	su tensión de ruptura.
Reduzca	la tensión de la fuente de alimentación a cerc
volts e	invierta su polaridad. Ajustela a menos 40 Vcd.
Los	dientes de sierra invierten su polaridad?
	Mida al igual qué en el procedimiento anterior le

amplitud de la tensión maxima de la forma de onda.

Amplitud de diente de sierra = Volts

d)

Amplitud de diente de sierra = Volts.

El voltaje de ruptura del DIAC es apróximadamente simétrico en ambas direcciones. La diferencia es típicamente menor que en un volts. Esto permite que un circuito de disparo mantenga prácticamente iguales los ángulos de disparo en ambos semiciclos de la fuente de tensión AC.

PRACTICA 16 CIRCUITO CONTROL DE FASE DIACZTRIAC

OBJETIVO:

A.- Mostrar la operación de un circuito de control de fase básico con DIAC/TRIAC.

INFORMACION INTRODUCTORIA

El TRIAC se dilliza primordialmente en los circuitos de control de energía de CA debido conducción bidireccional. En ambas alternaciones voltaje aplicado se entrega energía a la carga, con lo cuál se aprovecha mejor la energía disponible. Como TRIAC tiene cuatro modos de dispara independientes, se · pueden útilizar una diversidad de métodos de disparo. DIAC se diseño especialmente para disparar al TRIAC. El DIAC conduce y produce un pulso de corriente cuando su voltaje de ruptura es alcanzado en cualquiera de las direcciones. Por lo consiguiente puede suministrar de corriente de disparo para el cualquier polaridad TRIAC.

Al controlar la dirección de disparo del DIAC con respecto a la polaridad del voltaje a través de las términales del TRIAC, se puede controlar de manera efectiva la dirección del flujo de corriente y el ángulo de conducción de la energía entregada a la carga a través del TRIAC.

EQUIPO Y MATERIALES

~	FUENTE DE	ALIMENTACION	EMS8821
~	osciloscoi	210	
~	Q1	TRIAC	SC136B
~	Q2	DIAC	ST2
	C1		0.1 AF

	RI		. 22	ĽΚ
	R2	P07	100	ĸ
-	L1,L2,L3,L4	LAMP	6.5	V

- TABLERO DE INSTRUMENTOS

PROCEDIMIENTO

 a) El circuita de la figura 16.1 representa un circuito basico de control de fase que utiliza un MIAC para el disparo y un TRIAC para controlar la potencia entregada a la carga.

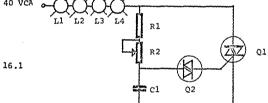


Figura 16.1

Al cerrarse el interruptor SI, el capacitor CI se carga a traves de las lámparas y de las resistencias RI y R2, hasta alcanzar la tensión de ruptura del PIAC; O2 en este punto el DIAC se dispara y entrega un pulso de corriente a la compuerta del TRIAC OI, la que hace que este se dispare y entregue energía durante es resto del ciclo de entrada. Cuando cambia la polaridad de la tensión de la fuente de alimentación CI se carga en la dirección opuesta, el DIAC se dispara entonces en el sentido contrario y el TRIAC conducira corriente a la carga también en dirección opuesta.

Variando la constante de tiempo de carga de R1/R2-C1 se varia el punto de disparo del TRIAC. Al hacerlo varía el ángulo de conducción del TRIAC y se controla la cantidad de energía que se entrega a la carga. Conecte el circuito de la figura 16.1.

h) Ajuste la fuente de alimentación a 40 Vca y R2 a su valor de máxima resistencia. Cierre SI y disminuya lentamente la resistencia R2.

Encienden las lámparas de pronto y brillantemente?

c) Aumente lentamente la resistencia de R2 hasta alcanzar su valor máximo. Disminuye notablemente la intensidad de las lámparas antes de apagarse?

La causa de que inicialmente las lámparas enciendan intempestivamente y brillantes y de que al apagarlas la disminución de la intensidad de su brillo sea más notable se conoce como HISTERISIS O CENTEELLEO.

d) Qué es la HSITERISIS?

PRUEDA DE CONOCIMIENTOS

- 1.- Explique cómo se puede evitar la Historisis?
- 2.- Que ventajas presenta un circuito de control de fase DIAC/TRIAC contra los circuitos de control de fase analizados anteriormente?
- 3.- Cómo es el pulso de disparo que suministra un DIAC?

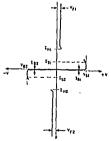
FRACTICA 17 CONTROL DE FASE CON SES-TRIAC

OBJETIVO:

.- Mostrar la operación de un circuito de control de fase

INFORMACION INTRODUCTORIA

La utilización de un dispositivo de disparo en el circuito de disparo de puerta de un TRIAC, presenta algunas ventajas importantes sobre los circuitos de control de puerta con una red RC simple. Estas ventajas parten del hocho de que un dispositivo de disparo entrega un pulso de corriente de puerta en lugar de un corriente de puerta sencidal. El interruptor bilateral de silicio SBS es utilizado en circuitos de control de baja tensión. Su tensión de ruptura es menor que para los DIACS; de 6 a 10 V y un coeficiente de temperatura de .02%/'C. Presenta las mísmas características bidireccionales que el DIAC pero la curva característica muestra una declinación de tensión más drástica despues que entra en estado de conducción. (Fig. 17.1)



El SBS es superior al DIAC ya que presenta unas características de conmutación más vigorosas, ya qué el SBS es más estable con la témperatura, más simétrico y presenta una dispersión de grupo menor.

La términal de puerta G de un SDS puede utilizarse para alterar su operación básica de disparo. Conectando un diodo zenner entre puerta G y cualquiera de las terminales AI o A2, la tensión de disparo cambiará al valor de la tensión zener Vz más la tensión de la juntura P-N interna.

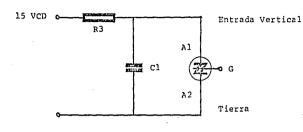
El SDS se utiliza principalmente en controles de fase con TRIACS ya que un arreglo adecuado puede reducir el fénomeno de historesis.

EQUIPO Y MATERIAL

-FUENTE DE ALIMENTA	CION	EMS8821
-OSCILOSCOPIO		
-01	SBS	204991
-02	TRIAC	SC136P
-R1	FOT	100 K
-R2		22 K
-R3		10 K
-C1		•22 AF
-D1	ZENER	6 V
-L1,L2	LAMP	6,5 V
-TABLERO DE EXPERIM	ENTOS	

FROCEDIMIENTO

- (. a) Conecte el oscilador de relajación simple de la fig. 17.2. El capacitor C1 se carga a la tensión del SBS y este se dispara.
 - b) Ajuste la fuente a una tensión de 15 V cd.
 - c) Aterrice momentaneamente la entrada vértical del osciloscopio, coloque el trazo en el centro de la pantalla (para tener una referencia a cero volts) y mida la tensión máxima positiva de la onda a través del SBS. Grafique la forma de onda.



Դmp 1	itud≔		VO	1	ţ.	S
-------	-------	--	----	---	----	---

d) Apague la fuente y cambie la polaridad de la tensión de la fuente. Indique si se invierte la polaridad de la onda

Amplitud= ∨o	1.	t,	5
--------------	----	----	---

e) Coloque un diodo zener de baja tensión (Vz < 6V) entre A1 y 6 para alterar la tensión de ruptura (VDo. Mida la tensión de disparo con ayuda del osciloscepio. Repita el procedimiento para A2 y 6 invirtiendo la polaridad de la fuente.

Amplituda

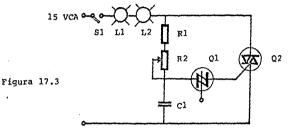
(A1+G)

	Amplitud=volts	
Varia el	valor de la tension de ruptura?	

unlite

2. a) El circuito de la figura 17.3 es un típico arreglo para el control de fase usando SBS. Cuando cerramos el interruptor SI, C1 comienza a cargarse a través de las lámparas y R1-R2, hasta alcanzar la tensión de ruptura del SBS, este se dispara y entrega un pulso de corriente a la compuerta del TRIAC disparancolo y haciendo que entregue energía a la carga.

Cuando se invierte la polaridad en el segundo semiciclo, la acción se repite poro el sentido de la corriente es opuesto. El disparo del SDS se controla con la constante de tiempo RC de R1/R2 y C1 con lo cuál se logra varíar el ángulo de conducción del triac.



b) Conecte el circuito, Ajuste la fuente de alimentación a 15 V ca y R2 para la máxima resistencia, Cierrre el interruptor S1 y disminuya lentamente la resistencia R2,

	AND THE PROPERTY OF THE PROPER
c)	Cómo controla R2 la intensidad de las lámparas?
• >	Conecte el osciloscopio y observe la forma de onda de
	tensión en la carga. Varie la resistencia R2 y mida los
	duquios máximo y mínimo de conducción al igual que en la práctica anterior.
	Angulo máximo≈ grados

Angulo mínimo= grados

e) Apague todo.

· Enciéndes las lámbaras?

χv

ESPECIFICACIONES SCORU EL DISEÑO DEL EQUIFO.

DESEMO

hunque la aceptación acádemica en español de la palabra diseño indica que sólo es la delineación o trazo de alguna cosa, su significado debe interpretarse como la acción y efecto de idear y planear la execución de alguna obra. El proceso de diseño principla con la consideración de problema y termina cuando se ha especificado o determinado completamente solución funcional. una economica satisfactoria en cualquier otro centido. Comprende e1enunciado o definición del problema, su analísis y sintésis, dispositivos, la predicción desdarrollo de er T funcionamiento, el temar la decisión de su execución, la optimización, las especificaciones, y, de heche, la mayoría de las técnicas y habilidados que se consideran parte método de la indenferia.

receso de disego

Inicialmento, el prosente trabojo esteba proyectado para presentar y comprobar los principles generales de los semiconductores de potencia más útilizados pere el control y conversión de energía, estudiando el comportamiento de los dispositives de estado sólido a base de experimentos de laboratorio y haciendo enfacís en que cada estudiante participe activamente en la ejecución de las prácticas y demostraciones.

Pero conforme se fue avanzando en el proyecto, se vió la necesidad de diseñar el equipo adecuado en el cuál implementar los experimentos de laboratorio, por no existir en el mercado algo que se adapte exáctamente a los requerimientos y necesidades de cáda práctica. Pera lograr el objetivo de cada experimento es necesario conectar un

circuito sencillo que iluntre los principios que se protenden democtrar. El problema es que no se dispone de un tablero que permita un rápido y fácil montaje de lo componentes que conforman el circuito, que a la vez proporcione la debida protección a los dispositivos eléctronicos y la sequeidad adecuada al estudiante encargado de realizar el experimento.

Se decidio analizar varias alternativas que consideran la solución del problema, a continuación se describen las ventajas y desventajas de cada una de ellas con el fin de que si se desea construir un tablero de experimentos que facilite la implementación de las prácticas enumeradas en este manual, se tomen en cuenta, y, si se decide se escoja la más apropiada de acuerdo a sus posibilidades.

El tablero de experimentos, físicamente debe de ostar compuesto de dos secciones, en la primera sección están ublicados los intercuptores, potenciometros y lámparas necesarios para implementar los circuitos de cáda experimento, La segunda sección ubica un sistema de tórminales que permite el acoplo de los dispositivos que forman parte de Cada circuito.(Fig. 4.1)

El objetivo principal del tablero de experimentos es su funcionalidad para fácilitar que 10% elementos cemiconductores se acomlem a él. Para esto, los estar mentados sobre una base de acrílico cava forma estara determinada por el admero de terminales del elemento. Lon dispositives de das terminales (resistencias. capacitores, diedos y diacs) van sobre una base de ferma muestra la. Fig. 4.2. Los orificios circularesfacilitan el rápido acomlo de la buse sobre el tablero y estan separados entre si apróximadamente 3 cm. Los elementos de tres electrodos (scr's y triacs) se acoplan a una base de transistor que ve sebre un acrilico triangular como el de la fig. 4.3, la disposición de los orificios Visueliza en la misma figura. La distancia entre los centros de los circulos forman un triangulo de 3 cm de base y 1.5 cm de alto.

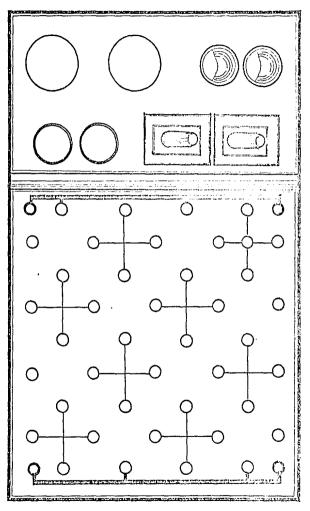
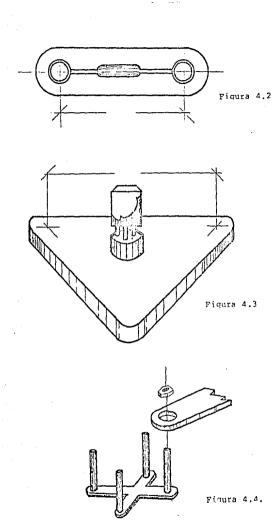


Figura 4.1

La sección del tablero que pérmite el acoplo de los elémentos eléctronicos esta compuesto por una serie de puntos en forma de cruz, los cuales no estan conectados entre si. Estas puntos vendrán a formar los nodos del circuito que se conecte y permitirán la comunicación de nodo con node a través de determinado dispositivo semiconductor y continuar el circuito en cuatro posibles direcciones. A lo largo del tablero, atravíesan dos líneas paralelas que con varias términales hacen que la tensión de la fuente este disponible a lo largo del tablero, para cuálquier elemento del circuito que lo necesite.

Tomando en cuenta factores comerciales, ecónomicos y técnicos, se escégieron tres soluciones posibles, las cuales vienen a ser diferentes entre sí por la forma en que van a ser acoplados los dispositivos eléctronicos al tablero.

- 1.- La primera opción considera el uso de tornillos en las cuatro tórminales del punto en forma de cruz los cuáles entrarán en los orificios de las basec de los dispositivos eléctronicos como lo indica la fig. 4.4. Los elementos se mantendran en su lugar con tuercas. En el centro de la cruz va colocado un plug o "hembra" para insertar las terminales de un instrumento de medición si es necesario. Esta opción es la más factible desde el punto de vista comercial y ecónomico, ya que lo necesario para la construcción del tablero se consigue fácilmente y a bajo costa, pero tiene la desventaja de qué es necesario el uso de tuercas para apretar las bases de los elementos y estas se extravian fácilmente y hacen muy tardado el precedimiento.
- 2.- La segunda alternativa, introduce una variante con respecto a la primera. Utiliza una especie de jack o "macho" en lugar de ternillo, este elimina la necesidad de tuercas ya que la base de los dispositivos ensamblaria ajustada y estos se mantendrian fijos facilmente, adémas, cuándo sea necesario cambiar algún elemento este se haría rápidamente. La fig. 4.5 nos muestra como sería el acoplo entre el tablero y el elemento eléctronico. La desventaja es que este sistema;



aunque más sencillo y rápido que el anterior, es más caro y la construcción del tablero es más laboriosa.

3.- La tercera opción es la mas práctica y el sistema es contrario al antérior. En este caso el jack o "macho" vá en la base del dispositivo eléctronico como lo muestra la fig. 4.6. En el tablero van colocados unos plugs o "hembros" dónde antés estaban situados los tornillos o jacks. Adémas los jacks de la base del dispositivo son del tipo de "acoplo", o sea que por la parte posterior tienen un orificio plug para que pueda acoplarse a ellos otro jack de menor calibre y esto elimina la necesidad del plug en el contro de la cruz y fácilita la medición de tensión o corriente en los dispositivos. Como ya se menciono antes, esta solución és la más práctica porque se elimina la posibilidad de un falso contacto, se legra que el ensamble de determinado circuito seá más rápido y fácilita la conexión de un instrumento de medición o el osciloscopio.

La desventaja es que los materiales necesarios con muy dificiles de conseguir en el mercado nacional y es la alternativa más cara.

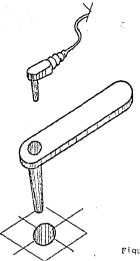
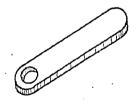


Figura 4.6



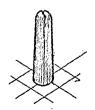


Figura 4.5

ME-UAG

ngng gananangn

MANUAL DE RECTIFICADORES CONTROLADOS DE

21132

FRANCISCO RUIZ VASSALLO EDICIONES CEAC

MANHAL DE RECTIFICADORES

FRANCISCO RUIZ VASSALLO EDICIONES CEÁC

<u>ego engineres ego mannal</u>

GENERAL ELECTRIC

TIPIOTOPIO Y TRIACS

HENRY ILLEN

MARCOMBO BOIXAREAU EDITORES

ELECTREVICA INDUSTRIAL

TIMOTHY J. MALONEY

EDITORIAL PRENTICEZHALL INTERNATIONAL

CONTROL DESIGNATES DEPOCHDICS Y APLICACIONES

EDITORIAL PRENTICEZHALL INTERNATIONAL

TRANSISTARES Y SEMICONDUCTIONES INDUSTRIALES

GUY A. LECLERO